DELPHION

035576/275 (Selection

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Terror West File Swed Selicities My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

The Delphion Integrated View

Buy Now: PDF | More choices Tools: Add to Work File: Create new Work View: INPADOC | Jump to: Top Go to: Derwent

DTWF015I: The execution of the system command failed at line 2992 with return code 512.

> JP2002038090A2: COMPOSITION FOR FILM FORMATION AND SILIC

P Derwent Title: Coat-forming compositions capable of short time calcination to give silica

coats with excellent crack resistance and low moisture absorption useful

for interlayer insulators for semiconductor devices [Derwent Record]

JP Japan ♥Country:

> ₽Kind: A2 Document Laid open to Public inspection i

SHINODA TOMOTAKA;

SUGIURA MAKOTO; SHIODA ATSUSHI: YAMADA KINJI:

JSR CORP

News, Profiles, Stocks and More about this company

2002-02-06 / 2000-07-31 Published / Filed:

₽Application

JP2000000231303

Number:

₽IPC Code: C09D 183/04; C08G 77/08; C09D 183/02; C09D 183/14;

Priority Number: 2000-05-15 JP2000000142101

> PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composition for silica PAbstract:

film formation capable of sintering in a short time, and excellent in cracking resistance and moisture absorption property as an

interlayer insulating material for a semiconductor element, etc., and

a silica film.

SOLUTION: This composition for film formation contains a compound (A) prepared by hydrolyzing and condensating at least a

compound selected from the group represented by general

formulae RaSi(OR1)4-a...(1), Si(OR2)4....(2) and R3b(R4O)3-bSi-(R7)d-Si(OR5)3-cR6c....(3), in the presence of a metal chelating compound and/or an alkali catalyst, an alkali compound (B), and an organic solvent (C). In the formula, R is H, F, or a monovalent organic group, R1 to R6 are each a monovalent organic group, R7 is O, a phenylene group, or -(CH2)n-, a is an integer of 1-2, b and c

are each a number of 0-2, d is a number of 0 or 1, and n is an

integer of 1-6.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

PFamily: None

8 Other Abstract CHEMABS 136(10)151971V DERABS C2002-345627

Info:



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-38090 (P2002-38090A)

(43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

エスアール株式会社内

エスアール株式会社内

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

(72)発明者 塩田 淳

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ			テーマコ	一)(多考)
C 0 9 D 183/04		C09D 18	3/04		4	J035
C08G 77/08		C 0 8 G 77/08 C 0 9 D 183/02			4J038	
C 0 9 D 183/02						٠.
183/14		183/14				
		審査請求	未請求	請求項の数7	OL	(全 24 頁)
(21)出願番号	特顧2000-231303(P2000-231303)	(71)出願人	000004178 ジェイエスアール株式会社			
(22)出顧日	平成12年7月31日(2000.7.31)	(72)発明者	東京都中央区築地2丁目11番24号 篠田 智隆			
(31)優先権主張番号	特顧2000-142101 (P2000-142101)	(1-7)2742		··· ·央区築地二丁	目11番2	4号 ジェイ
(32)優先日	平成12年5月15日(2000.5.15)		エスアー	ル株式会社内		•
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	杉浦 誠	E		
			東京都中	央区築地二丁][1][[1][[1][[1][[1][[1][[1][[1][[1][[1	4号 ジェイ

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 膜形成用組成物およびシリカ系膜

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、短時間焼成が可能であり、クラック耐性、低吸湿性 に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用組成物およびシリカ系膜

【解決手段】 (A) それぞれ下記一般式(1)、

(2)、(3)で表される化合物の群から選ばれた少なくとも1種の化合物を金属キレート化合物および或いはアルカリ触媒の存在下に、加水分解、縮合してなる化合物、(B)アルカリ化合物ならびに(C)有機溶媒を含有する膜形成用組成物。

 R_* S i (OR¹) ... (1)

Si(OR'), $\cdots \cdot (2)$

 R^{3} , $(R^{4} O)_{3-b} Si - (R^{7})_{4} - Si (OR)_{4}$

') 3-c R'c · · (3)

(式中RはH、F、又は一価の有機基、R¹ \sim R⁶ は一価の有機基、R¹ はO、フェニレン基又は- (CH_2)。-、aは $1\sim2$ の整数、b、cは $0\sim2$ の数、dは0または1、nは $1\sim6$ の整数を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1)下記一般式(1)で 表される化合物、

 R_* S i $(OR^1)_{\bullet-\bullet}$ \cdots (1)

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 *

〔式中、 $R^3 \sim R^6$ は同一または異なり、それぞれ1価 の有機基、b~cは同一または異なり、0~2の整数、 R' は酸素原子、フェニレン基または- (CH,)。-で表される基(ここで、nは $1\sim6$ の整数である)、d 10 とする請求項2記載の膜形成用組成物物。 は0または1を示す。〕の群から選ばれた少なくとも1 種の化合物を金属キレート化合物およびアルカリ触媒も しくはいずれか一方の存在下に、加水分解、縮合してな る加水分解縮合物、

- (B) アルカリ化合物ならびに
- (C) 有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組 成物。

【請求項2】 (B) 成分が有機アミンおよびその塩か ら選ばれる少なくとも1種であることを特徴とする請求※ RO (CHCH, CH, O) R'

(R'およびR'は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)

【請求項6】 (A)成分に対する(B)成分の使用割 合が、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換 算) に対して(B) 成分0.001~5重量部である ことを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項7】 請求項1記載の膜形成用組成物を硬化 してなることを特徴とするシリカ系膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に 関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶 縁膜材料として、短時間焼成が可能であり、クラック耐 性、低吸湿性に優れたシリカ系膜が形成可能な膜形成用 組成物およびシリカ系膜に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁 膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシ リカ(SiO、)膜が多用されている。そして、近年、 より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、S OG (Spin on Glass) 膜と呼ばれるテト ラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布 型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導 体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポ リオルガノシロキサンを主成分とする低比誘電率の層間 絶縁膜が開発されている。特に半導体素子などのさらな る高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶 緑性が要求されており、したがって、より低比誘電率で かつ短時間焼成が可能であり、クラック耐性、低吸湿性 50 Si(OR²)。

*基、R1 は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) (A-2)下記一般式(2)で表される化合物、および

Si(OR'), $\cdots (2)$

(式中、R'は1価の有機基を示す。)

(A-3)下記一般式(3)で表される化合物

 R^{3}_{b} (R'O) $_{3:b}$ Si - (R') $_{4}$ - Si (OR') $_{3:c}$ R' · · (3)

※項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 有機アミンがアルキルアミン、環状アミ ン、含窒素オニウムからなる群から選ばれることを特徴

【請求項4】 含窒素オニウムが(B-1)窒素含有化 合物と(B-2)アニオン性基含有化合物およびハロゲ ン化合物から選ばれる少なくとも1種とから形成される ものであるこを特徴とする請求項3記載の膜形成用組成 物。

【請求項5】 (C)有機溶剤が、下記一般式(4)で 表される化合物であることを特徴とする請求項1記載の 膜形成用組成物。

 $\cdots \cdots (4)$

に優れる層間絶縁膜材料が求められるようになってい る。

【0003】低比誘電率の材料としては、アンモニアの 存在下にアルコキシシランを縮合して得られる微粒子と アルコキシシランの塩基性部分加水分解物との混合物か らなる組成物(特開平5-263045、同5-315 319)や、ポリアルコキシシランの塩基性加水分解物 をアンモニアの存在下縮合することにより得られた塗布 液(特開平11-340219、同11-34022

30 0)が提案されているが、これらの方法で得られる材料 は、反応の生成物の性質が安定せず、短時間焼成、クラ ック耐性、低吸湿性膜特性のバラツキも大きいため、エ 業的生産には不向きであった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点 を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しく は、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、短時間 焼成が可能であり、クラック耐性、低吸湿性に優れた膜 形成用組成物および該組成物から得られるシリカ系膜を 提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、

(A) (A-1)下記一般式(1)で表される化合物 (以下「化合物(1)」という)、

 R_* Si (OR¹) ... · · · · · (1)

(式中、Rは水素原子、フッ素原子または1価の有機 基、R¹ は1価の有機基、aは1~2の整数を示す。) (A-2)下記一般式(2)で表される化合物(以下、 「化合物(2)」という)および

(式中、R'は1価の有機基を示す。)

*「化合物(3)」という)

(A-3) 下記一般式(3) で表される化合物(以下、*

 R^{3}_{b} $(R^{4} O)_{3-b} Si - (R^{7})_{4} - Si (OR^{5})_{3-c} R^{6}_{c} \cdots$ $\cdot \cdot (3)$

〔式中、 $^{\bullet}R^{\dagger}$ ~ R^{\bullet} は同一または異なり、それぞれ 1 価 の有機基、b~cは同一または異なり、0~2の整数、 R'は酸素原子、フェニレン基または-(CH₂)。-で表される基(ととで、nはl~6の整数である)、d は0または1を示す。〕の群から選ばれた少なくとも1 しくはいずれか一方の存在下に、加水分解、縮合してな る加水分解縮合物、

(B)アルカリ化合物ならびに

(C) 有機溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組 成物に関する。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を 基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜の形成方法 に関する。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって 得られるシリカ系膜に関する。

[0006]

縮合物とは、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種のシラン化合物の加水分解物、縮合物 である。ととで、(A)成分における加水分解では、上 記(A)成分を構成する化合物(1)~(3)に含まれ るR'O-基、R'O-基、R'O-基およびR'O-基のすべてが加水分解されている必要はなく、例えば、 1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分 解されているもの、あるいは、これらの混合物であって もよい。また、(A)成分における縮合とは、(A)成 ノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成すること であるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合して いる必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合した もの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも 包含した概念である。

【0007】(A)加水分解縮合物

(A)加水分解縮合物は、上記化合物(1)~(3)の 群から選ばれた少なくとも 1 種のシラン化合物を触媒の 存在下に、加水分解、縮合して得られる。

1 の1価の有機基としては、アルキル基、アリール基、 アリル基、グリシジル基などを挙げることができる。ま た、一般式(1)において、Rは1価の有機基、特にア ルキル基またはフェニル基であることが好ましい。ここ で、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピ ル基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~ 5であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐してい てもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換され ていてもよい。一般式(1)において、アリール基とし ては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エ 50 ec-ブトキシシラン、n-ブチルトリーtert-ブ

チルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル 基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。 【0008】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、トリメトキシシラン、トリエトキシシラン、ト リーnープロポキシシラン、トリーisoープロポキシ 種の化合物を金属キレート化合物およびアルカリ触媒も 10 シラン、トリーn-ブトキシシラン、トリーsec-ブ トキシシラン、トリーtert‐ブトキシシラン、トリ フェノキシシラン、フルオロトリメトキシシラン、フル オロトリエトキシシラン、フルオロトリーnープロポキ シシラン、フルオロトリーiso-プロポキシシラン、 フルオロトリーn-ブトキシシラン、フルオロトリーs ecーブトキシシラン、フルオロトリーtertーブト キシシラン、フルオロトリフェノキシシランなど; 【0009】メチルトリメトキシシラン、メチルトリエ トキシシラン、メチルトリーn-プロポキシシラン、メ 【発明の実施の形態】本発明において、(A)加水分解 20 チルトリーiso-ブロポキシシラン、メチルトリーn ープトキシシラン、メチルトリーsec-ブトキシシラ ン、メチルトリーtert-ブトキシシラン、メチルト リフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチ ルトリエトキシシラン、エチルトリーnープロポキシシ ラン、エチルトリーiso-プロポキシシラン、エチル トリーnープトキシシラン、エチルトリーsecープト キシシラン、エチルトリーtert‐ブトキシシラン、 エチルトリフェノキシシラン、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリーnープロ 分を構成する化合物(1)~(3)の加水分解物のシラ 30 ポキシシラン、ビニルトリーiso-プロポキシシラ ン、ビニルトリーnーブトキシシラン、ビニルトリーs ecープトキシシラン、ビニルトリーtertープトキ シシラン、ビニルトリフェノキシシラン、n-プロビル トリメトキシシラン、n-プロピルトリエトキシシラ ン、n-プロピルトリーn-プロポキシシラン、n-プ ロビルトリーisoープロポキシシラン、nープロビル トリーnープトキシシラン、nープロピルトリーsec ープトキシシラン、nープロピルトリーtertープト キシシラン、n-プロピルトリフェノキシシラン、i-化合物(1):上記一般式(1)において、RおよびR 40 プロビルトリメトキシシラン、i-プロビルトリエトキ シシラン、i-プロピルトリーn-プロポキシシラン、 i-プロピルトリーiso-プロポキシシラン、i-プ ロピルトリーnーブトキシシラン、iープロピルトリー sec-プトキシシラン、i-プロピルトリーtert -ブトキシシラン、i-プロピルトリフェノキシシラ ン、n-ブチルトリメトキシシラン、n-ブチルトリエ トキシシラン、n-ブチルトリ-n-プロポキシシラ ン、n-ブチルトリ-iso-プロポキシシラン、n-ブチルトリーn - ブトキシシラン、n - ブチルトリーs

トキシシラン、n‐ブチルトリフェノキシシラン、se c-ブチルトリメトキシシラン、sec-ブチルトリエ トキシシラン、sec-ブチル-トリ-n-プロポキシ シラン、sec‐ブチル‐トリ‐iso‐プロポキシシ ラン、sec-ブチルートリーn-ブトキシシラン、s ecープチルートリーsecーブトキシシラン、sec ープチルートリーtertープトキシシラン、sec-ブチル-トリフェノキシシラン、t-ブチルトリメトキ シシラン、tーブチルトリエトキシシラン、tーブチル -プロポキシシラン、t-ブチルトリ-n-ブトキシシ ラン、t-ブチルトリ-sec-ブトキシシラン、t-ブチルトリーtert‐ブトキシシラン、t‐ブチルト リフェノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フ ェニルトリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポ キシシラン、フェニルトリーiso-プロポキシシラ ン、フェニルトリーn-ブトキシシラン、フェニルトリ -sec-ブトキシシラン、フェニルトリーtert-ブトキシシラン、フェニルトリフェノキシシラン。ビニ ーアミノプロビルトリメトキシシラン、ャーアミノプロ ピルトリエトキシシラン、ケーグリシドキシプロピルト リメトキシシラン、ァーグリシドキシプロピルトリエト キシシラン、アートリフロロプロピルトリメトキシシラ ン、ァートリフロロプロピルトリエトキシシランなど: 【0010】 ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエ トキシシラン、ジメチルージーn-プロポキシシラン、 ジメチルージーisoープロポキシシラン、ジメチルー ジーnーブトキシシラン、ジメチルージーsecーブト キシシラン、ジメチルージー tertーブトキシシラ ン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシ シラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルージーn -プロポキシシラン、ジエチル-ジ-iso-プロポキ シシラン、ジエチルージーnーブトキシシラン、ジエチ ルージーsecープトキシシラン、ジエチルージーte rtープトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、 ジーnープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピル ジエトキシシラン、ジーnープロピルージーnープロポ キシシラン、ジーn-プロピルージーiso-プロポキ シシラン、ジーnープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジーnープロピルージーsecーブトキシシラン、 ジーnープロピルージーtertーブトキシシラン、ジ -n-プロピルージーフェノキシシラン、ジーiso-プロビルジメトキシシラン、ジーiso-プロビルジエ トキシシラン、ジーiso-ブロピルージーn-プロポ

キシシラン、ジーiso-プロピルージーiso-プロ

ポキシシラン、ジーiso-プロピルージーn-ブトキ

シシラン、ジーisoープロピルージーsecープトキ

シシラン、ジーisoープロピルージーtertーブト

ラン、ジ-n-ブチルジメトキシシラン、ジ-n-ブチ ルジエトキシシラン、ジーn-ブチル-ジーn-プロポ キシシラン、ジーn-ブチルージーiso-プロポキシ シラン、ジーnーブチルージーnーブトキシシラン、ジ -n-ブチルージ-sec-ブトキシシラン、ジ-n-ブチルージーtertープトキシシラン、ジーnープチ ルージーフェノキシシラン、ジーSecーブチルジメト キシシラン、ジーSec‐ブチルジェトキシシラン、ジ -sec-ブチルージ-n-プロポキシシラン、ジ-s トリーn - プロポキシシラン、t - ブチルトリーi s o 10 e c - ブチルージーi s o - プロポキシシラン、ジー s ecープチルージーnープトキシシラン、ジーsecー ブチルージーsec-ブトキシシラン、ジーsec-ブ チルージーtertーブトキシシラン、ジーsecーブ チルージーフェノキシシラン、ジーtertーブチルジ メトキシシラン、ジーtert‐ブチルジエトキシシラ ン、ジーtert-プチルージ-n-プロポキシシラ ン、ジーtert-ブチルージーiso-プロポキシシ ラン、ジーtertーブチルージーnーブトキシシラ ン、ジーteェtープチルージーsecープトキシシラ ルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、7~20~ン、ジーtert-ブチルージーtert-ブトキシシ ラン、ジーtertーブチルージーフェノキシシラン、 ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージーエトキ シシラン、ジフェニルージーnープロポキシシラン、ジ フェニルージーisoープロポキシシラン、ジフェニル -ジーn-ブトキシシラン、ジフェニル-ジーsec-プトキシシラン、ジフェニルージーtert-ブトキシ シラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジピニルトリ メトキシシランなど:を挙げることができる。

> 【0011】化合物(1)として好ましい化合物は、メ 30 チルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 メチルトリーnープロポキシシラン、メチルトリーis 0-プロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ チルトリエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、 ビニルトリエトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシ シラン、ジメチルジエトキシシラン、ジェチルジメトキ シシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジメ トキシシラン、ジフェニルジエトキシシランなどであ る。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用して 40 もよい。

【0012】化合物(2);上記一般式(2)におい て、R'で表される1価の有機基としては、先の一般式 (1) と同様な有機基を挙げることができる。一般式

(2)で表される化合物の具体例としては、テトラメト キシシラン、テトラエトキシシラン、テトラーnープロ ポキシシラン、テトラーiso-プロポキシシラン、テ トラーn-ブトキシラン、テトラ-sec-ブトキシシ ラン、テトラーtert-ブトキシシラン、テトラフェ ノキシシランなどが挙げられる。

キシシラン、ジーiso-プロピルージーフェノキシシ 50 【0013】化合物(3):上記一般式(3)におい

て、R'~R'で表される1価の有機基としては、先の 一般式(1)と同様な有機基を挙げることができる。一 般式(3)のうち、R'が酸素原子の化合物としては、 ヘキサメトキシジシロキサン、ヘキサエトキシジシロキ・ サン、ヘキサフェノキシジシロキサン、1, 1, 1, 3. 3-ペンタメトキシ-3-メチルジシロキサン、 1. 1. 1. 3. 3 - ペンタエトキシー3 - メチルジシ ロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシー3 ーメチルジシロキサン、1、1、1、3、3ーペンタメ ーペンタエトキシー3-エチルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタフェノキシ-3-エチルジシロキサ ン、1、1、1、3、3ーペンタメトキシー3ーフェニ ルジシロキサン、1, 1, 1, 3, 3-ペンタエトキシ -3-フェニルジシロキサン、1.1.1.3.3-ベ ンタフェノキシー3-フェニルジシロキサン、1,1, 3, 3-テトラメトキシ-1, 3-ジメチルジシロキサ ン、1、1、3、3-テトラエトキシ-1、3-ジメチ ルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー ラメトキシー1、3ージエチルジシロキサン、1、1、 ン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1, 3-ジエ チルジシロキサン、1、1、3、3-テトラメトキシー 1, 3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラエトキシー1,3-ジフェニルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テトラフェノキシー1, 3-ジフェニルジ シロキサン、1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1,1,3-トリエトキシー リフェノキシー1,3,3-トリメチルジシロキサン、 1, 1, 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリエチルジ シロキサン、、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3 ートリエチルジシロキサン、、1,1,3ートリフェノ キシー1, 3, 3ートリエチルジシロキサン、、1. 1. 3-トリメトキシ-1, 3, 3-トリフェニルジシ ロキサン、1, 1, 3-トリエトキシ-1, 3, 3-ト リフェニルジシロキサン、1,1,3-トリフェノキシ -1,3,3-トリフェニルジシロキサン、1,3-ジ メトキシー1, 1, 3, 3ーテトラメチルジシロキサ ン、1,3-ジェトキシ-1,1,3,3-テトラメチ ルジシロキサン、1,3-ジフェノキシ-1,1,3, 3-テトラメチルジシロキサン、1.3-ジメトキシー 1, 1, 3, 3-テトラエチルジシロキサン、1, 3-ジェトキシー1、1、3、3ーテトラエチルジシロキサ チルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1,3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1、3-ジエトキシ -1, 1, 3, 3-テトラフェニルジシロキサン、1,

シロキサンなどを挙げることができる。

(5)

【0014】 これらのうち、 ヘキサメトキシジシロキサ ン、ヘキサエトキシジシロキサン、1, 1, 3, 3-テ トラメトキシー1、3-ジメチルジシロキサン、1、 1, 3, 3-テトラエトキシ-1, 3-ジメチルジシロ キサン、1、1、3、3-テトラメトキシ-1、3-ジ フェニルジシロキサン、1,3-ジメトキシ-1,1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, 3-ジェトキ シ-1, 1, 3, 3-テトラメチルジシロキサン、1, トキシー3-エチルジシロキサン、1,1,1,3,3 10 3-ジメトキシー1,1,3,3-テトラフェニルジシ ロキサン、1, 3-ジエトキシ-1, 1, 3, 3-テト ラフェニルジシロキサンなどを、好ましい例として挙げ ることができる。

【0015】また、一般式(3)において、dが0の化 合物としては、ヘキサメトキシジシラン、ヘキサエトキ シジシラン、ヘキサフェノキシジシラン、1、1、1、 2, 2-ペンタメトキシ-2-メチルジシラン、1, 1、1、2、2-ペンタエトキシ-2-メチルジシラ ン、1、1、1、2、2-ペンタフェノキシー2-メチ 1, 3-ジメチルジシロキサン、1, 1, 3, 3-テト 20 ルジシラン、1, 1, 1, 2, 2-ペンタメトキシ-2 -エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタエトキ シー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2-ペンタ フェノキシー2-エチルジシラン、1,1,1,2,2 -ペンタメトキシー2ーフェニルジシラン、1、1、 1, 2, $2 - \alpha \rightarrow x + 5 - 2 - 7 = 1 + 5 = 2$. 1, 1, 1, 2, 2-ペンタフェノキシー2-フェニル ジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエトキシー 1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフ 1, 3, 3-トリメチルジシロキサン、1, 1, 3-ト 30 ェノキシ-1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2 -テトラメトキシー1,2-ジエチルジシラン、1. 1, 2, 2-テトラエトキシー1, 2-ジエチルジシラ (2, 1, 1, 2, 2-7)チルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシー1,2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラエト キシー1, 2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラフェノキシー1,2-ジフェニルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリメチルジシラ (2, 1, 1, 2-1)40 $\mu \ni \ni \ni \supset 1, 1, 2 - \vdash \vdash \vdash \supset 1, 2, 2$ -トリメチルジシラン、1, 1, 2-トリメトキシー 1, 2, 2-トリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリ エトキシー1, 2, 2ートリエチルジシラン、、1, 1, 2-トリフェノキシー1, 2, 2-トリエチルジシ ラン、、1, 1, 2-トリメトキシ-1, 2, 2-トリ フェニルジシラン、1,1,2-トリエトキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、、1, 1, 2-トリフ ェノキシー1, 2, 2-トリフェニルジシラン、1, 2 -ジメトキシー1、1、2、2 - テトラメチルジシラ 3-ジフェノキシー1, 1, 3, 3-テトラフェニルジ 50 ン、1, 2-ジエトキシー1, 1, 2, 2-テトラメチ

(6)

ルジシラン、1,2-ジフェノキシ-1,1,2,2-テトラメチルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジェトキシー 1, 1, 2, 2-テトラエチルジシラン、1, 2-ジフ ェノキシー1, 1, 2, 2ーテトラエチルジシラン、 1, 2-ジメトキシ-1, 1, 2, 2-テトラフェニル ジシラン、1,2-ジェトキシー1,1,2,2-テト ラフェニルジシラン、1,2-ジフェノキシー1,1, 2. 2-テトラフェニルジシランなどを挙げることがで きる。

【0016】 これらのうち、ヘキサメトキシジシラン、 ヘキサエトキシジシラン、1,1,2,2-テトラメト キシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テ トラエトキシー1, 2-ジメチルジシラン、1, 1, 2, 2-テトラメトキシ-1, 2-ジフェニルジシラ ン、1,2-ジメトキシー1,1,2,2-テトラメチ ルジシラン、1,2-ジエトキシ-1,1,2,2-テ トラメチルジシラン、1,2-ジメトキシ-1,1, 2, 2-テトラフェニルジシラン、1, 2-ジエトキシ -1, 1, 2, 2-テトラフェニルジシランなどを、好 20 1, 2-ビス (ジーt-ブトキシメチルシリル) エタ ましい例として挙げることができる。

【0017】さらに、一般式(3)において、R⁷が-(CH、)。-で表される基の化合物としては、ビス (トリメトキシシリル) メタン、ビス(トリエトキシシ リル) メタン、ビス (トリーn-プロポキシシリル) メ タン、ビス(トリーi-プロポキシシリル)メタン、ビ ス(トリーn-ブトキシシリル)メタン、ビス(トリー sec-ブトキシシリル) メタン、ビス (トリーt-ブ トキシシリル) メタン、1,2-ビス(トリメトキシシ タン、1,2-ビス(トリーn-プロポキシシリル)エ タン、1,2-ビス(トリーi-プロポキシシリル)エ タン、1、2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)エタ ン、1,2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)エ タン、1, 2-ビス(トリーt-ブトキシシリル)エタ ン、1-(ジメトキシメチルシリル)-1-(トリメト キシシリル)メタン、1-(ジェトキシメチルシリル) -1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジ-n-プロポキシメチルシリル) -1-(トリ-n-プロポキ シシリル) メタン、1 - (ジ-i-プロポキシメチルシ 40 リル)-1-(トリ-i-プロポキシシリル)メタン、 1-(ジ-n-ブトキシメチルシリル)-1-(トリー n-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ-sec-ブト キシメチルシリル)-1-(トリーsec-ブトキシシ リル) メタン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル) -1-(トリーt-ブトキシシリル) メタン、1-(ジ メトキシメチルシリル) -2-(トリメトキシシリル) エタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-2-(トリ エトキシシリル) エタン、1-(ジ-n-プロポキシメ **チルシリル)−2−(トリ−n−プロポキシシリル)エ 50 (トリメトキシシリル)エタン、1−(ジエトキシメチ**

タン、1-(ジ-i-プロポキシメチルシリル)-2-(トリーi-プロポキシシリル) エタン、1-(ジ-n -ブトキシメチルシリル) -2- (トリ-n-ブトキシ シリル) エタン、1-(ジ-sec-ブトキシメチルシ リル) -2-(トリーsec-ブトキシシリル) エタ ン、1-(ジ-t-ブトキシメチルシリル)-2-(ト リー t - ブトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメ チルシリル) メタン、ビス (ジェトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-n-プロポキシメチルシリル) メタ 10 ン、ビス(ジーi-プロポキシメチルシリル)メタン。 ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-sec-ブトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジ-t-ブトキシメチルシリル) メタン、1、2-ビ ス(ジメトキシメチルシリル)エタン、1、2-ビス (ジエトキシメチルシリル) エタン、1, 2-ビス (ジ -n-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーi-プロポキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーn-ブトキシメチルシリル) エタン、1、2 -ビス (ジ-sec-ブトキシメチルシリル) エタン、 ン、1,2-ピス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 2 -ビス(トリ-n-プロポキシシリル)ベンゼン、1. 2-ビス (トリーi-プロポキシシリル) ベンゼン、 1,2-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン 1. 2-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,2-ビス(トリ-t- ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン 1, 3-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1, 3 リル) エタン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エ 30 -ビス(トリーn-プロポキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン、 1.3-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1、3-ビス(トリーt-ブトキシシリル) ベンゼ ン、1,4-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1, 4 -ビス(トリーn-プロポキシシリル)ベンゼン、1, 4-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベンゼン、 1, 4-ビス(トリーn-ブトキシシリル)ベンゼン 1.4-ビス(トリーsec-ブトキシシリル)ベンゼ ン、1,4-ビス(トリーt-ブトキシシリル)ベンゼ ンなど挙げることができる。

【0018】 これらのうち、ビス (トリメトキシシリ ル) メタン、ビス(トリエトキシシリル) メタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル)エタン、1,2-ビス (トリエトキシシリル) エタン、1-(ジメトキシメチ ルシリル)-1-(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル)-1-(トリエトキシシリ ル) メタン、1-(ジメトキシメチルシリル)-2ルシリル) -2-(トリエトキシシリル) エタン、ビス (ジメトキシメチルシリル) メタン、ビス (ジエトキシ メチルシリル) メタン、1,2-ビス (ジメトキシメチ ルシリル) エタン、1,2-ビス(ジェトキシメチルシ リル) エタン、1, 2-ビス(トリメトキシシリル) ベ ンゼン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)ベンゼ ン、1,3-ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、 1, 3-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、1.4 - ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1、4 - ビス て挙げることができる。本発明において、化合物(1) ~(3)としては、1種もしくは2種以上を用いること ができる。

【0019】なお、上記化合物(1)~(3)の群から 選ばれた少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮 合させる際に、化合物(1)~(3)1モル当たり0. 5モルを越え150モル以下の水を用いることが好まし く、0.5モルを越え130モルの水を加えることが特 に好ましい。

【0020】本発明の(A)加水分解縮合物を製造する 20 トリス(エチルアセトアセテート)チタン、ピス(アセ に際しては、上記化合物(1)~(3)の群から選ばれ た少なくとも1種のシラン化合物を加水分解、縮合させ る際に、触媒を用いることが特徴である。この際に用い ることの出来る触媒としては、金属キレート化合物、ア ルカリ触媒が挙げられる。金属キレート化合物として は、例えば、トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) チタン、トリーnープロポキシ・モノ (アセチルア セトナート) チタン、トリー i -プロポキシ・モノ (ア セチルアセトナート)チタン、トリーn-ブトキシ・モ ノ(アセチルアセトナート)チタン、トリーsec-ブ 30 ルコニウム、トリーt-ブトキシ・モノ(アセチルアセ トキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリー t-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、 ジエトキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジ -n-プロポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタ ン、ジー i - プロポキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) チタン、ジ-n-ブトキシ・ビス (アセチルアセト ナート) チタン、ジーsec-ブトキシ・ビス (アセチ・ ルアセトナート) チタン、ジーt-ブトキシ・ビス (ア セチルアセトナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーn - プロポキ 40 - n - プロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジ シ・トリス (アセチルアセトナート) チダン、モノーi -プロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタ ン、モノーn-ブトキシ・トリス(アセチルアセトナー ト) チタン、モノーsec-ブトキシ・トリス (アセチ ルアセトナート) チタン、モノー t - ブトキシ・トリス **(アセチルアセトナート)チタン、テトラキス(アセチ** ルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチル アセトアセテート) チタン、トリーn-プロポキシ・モ ノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリーi-プロ

-n-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリーsec-ブトキシ・モノ(エチルアセトアセ テート) チタン、トリーt-ブトキシ・モノ (エチルア セトアセテート) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルア セトアセテート) チタン、ジーn - プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーi-プロポキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーn-プトキシ・ピス (エチルアセトアセテート) チタン、ジ -sec-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) (トリエトキシシリル) ベンゼンなどを好ましい例とし 10 チタン、ジーt-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテ ート) チタン、モノエトキシ・トリス (エチルアセトア セテート) チタン、モノー n ープロポキシ・トリス (エ チルアセトアセテート) チタン、モノーi-プロポキシ ·トリス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ-n -ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーSec-ブトキシ・トリス(エチルアセトア セテート) チタン、モノー t - ブトキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート)チタン、テトラキス(エチルアセ トアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) チルアセトナート) ビス (エチルアセトアセテート) チ タン、トリス(アセチルアセトナート)モノ(エチルア セトアセテート)チタンなどのチタンキレート化合物: トリエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニ ウム、トリーn-プロポキシ・モノ(アセチルアセトナ ート)ジルコニウム、トリーi-プロポキシ・モノ(ア セチルアセトナート) ジルコニウム、トリーn-ブトキ シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -sec-プトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジ トナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジーn - プロポキシ・ビ ス(アセチルアセトナート)ジルコニウム、ジーiープ ロポキシ・ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジ-n-ブトキシ・ビス(アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーSec-ブトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジー t ーブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノエトキシ ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノ ルコニウム、モノーi-プロポキシ・トリス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノー n - ブトキシ・ト リス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー s ec-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジル コニウム、モノー t ープトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセト ナート) ジルコニウム、トリエトキシ・モノ (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、トリーn-プロポキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ ポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリ 50 - i - プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ

(8)

ミン、トリプチルアミン、シクロヘキシルアミン、トリ メチルイミジン、1-アミノ-3-メチルブタン、ジメ

チルグリシン、3-アミノ-3-メチルアミンなどを挙 げることができ、より好ましくは有機アミンであり、ア ンモニア、アルキルアミンおよびテトラメチルアンモニ ウムハイドロオキサイドがシリカ系膜の基板への密着性 の点から特に好ましい。これらのアルカリ触媒は1種あ

るいは2種以上を同時に使用しても良い。 【0022】上記触媒の使用量は、化合物(1)~

(3)中のR'O-基,R'O-基,R'O-基および R'O-基で表される基の総量1モルに対して、通常、 0.00001~10モル、好ましくは0.00005 ~5 モルである。触媒の使用量が上記範囲内であれば、 反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ない。

【0023】なお、(A)成分中、各成分を完全加水分 解縮合物に換算したときに、化合物(2)は、化合物

(1)~(3)の総量中、5~75重量%、好ましくは 10~70重量%、さらに好ましくは15~70重量% である。また、化合物(1)および/または(3)は、

ましくは90~30重量%、さらに好ましくは85~3 0重量%である。化合物(2)が、化合物(1)~

(3) の総量中、5~75重量%であることが、得られ る塗膜の弾性率が高く、かつ低誘電性に特に優れる。と とで、本発明において、完全加水分解縮合物とは、化合 物(1)~(3)中のR¹ O-基, R¹ O-基, R¹ O -基およびR'O-基が100%加水分解してSiOH 基となり、さらに完全に縮合してシロキサン構造となっ たものをいう。また、(A)成分としては、得られる組

アルミニウムのキレート化合物、特に好ましくはチタン 30 成物の貯蔵安定性がより優れるので、化合物 (1) およ び化合物(2)の加水分解縮合物であることが好まし

【0024】(B)成分

本発明に使用する(B)成分としてはのアルカリ化合物 であり、好ましくは有機アミンおよびその塩である。有 機アミンとしては、アルキルアミン、環状アミン化合 物、含窒素オニウムなどが挙げられ、塩としては有機酸 塩などを挙げることができる。

【0025】上記アルキルアミンとしては、例えばメチ オクタン、ジアザビシクロノナン、ジアザビシクロウン 40 ルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミ ン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルアミ ン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、 N, N-ジメチルアミン、N, N-ジエチルアミン、 N, N-ジプロピルアミン、N, N-ジプチルアミン、 トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルア ミン、トリブチルアミン、シクロヘキシルアミン、モノ エタノールアミン、ジエタノールアミン、トリエタノー ルアミンなどを挙げることができる。

【0026】上記環状アミン化合物としては、例えばピ トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロビルア 50 リジン、ピラゾール、2 - ピラゾリン、ベンゾビラゾー

ルコニウム、トリーn-ブトキシ・モノ (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、トリーSec‐ブトキシ・ モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリー t-ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、ジェトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーn-プロポキシ・ビス (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、ジー i -プロポキシ・ビ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーn-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ジーsec‐ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテ 10 ート) ジルコニウム、ジーt-ブトキシ・ビス (エチル アセトアセテート) ジルコニウム、モノエトキシ・トリ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー n -プロポキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノー i - プロポキシ・トリス (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、モノー n - ブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー sec-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー t - プトキシ・トリス (エチルア セトアセテート)ジルコニウム、テトラキス(エチルア 20 化合物(1)~(3)の総量中、95~25重量%、好 セトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセト ナート) トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ ム、ビス(アセチルアセトナート)ビス(エチルアセト アセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナ ート) モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウムな どのジルコニウムキレート化合物:トリス(アセチルア セトナート) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセ テート) アルミニウムなどのアルミニウムキレート化合 物:などを挙げることができ、好ましくはチタンまたは のキレート化合物を挙げることができる。これらの金属 キレート化合物は、1種あるいは2種以上を同時に使用 しても良い。

【0021】アルカリ触媒としては、例えば、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、ピリジ ン、ピロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、 ピコリン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、ジメチルモノエタノールアミン、モノメチルジエタ ノールアミン、トリエタノールアミン、ジアザビシクロ デセン、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイ ド、テトラエチルアンモニウムハイドロオキサイド、テ トラプロビルアンモニウムハイドロオキサイド、テトラ ブチルアンモニウムハイドロオキサイド、アンモニア、 メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチル アミン、ペンチルアミン、ヘキシルアミン、ペンチルア ミン、オクチルアミン、ノニルアミン、デシルアミン、 N. N-ジメチルアミン、N. N-ジエチルアミン、 N, N-ジプロピルアミン、N, N-ジブチルアミン、

ル、イミダゾール、メチルイミダゾール、ベンゾイミダ ゾール、ベンゾピリダジン、キナゾリン、キナジン、ジ アザビシクロオクタン、ジアザビシクロノナン、ジアザ ビシクロウンデセン、1、2-ジメチル-1,4,5, 6-テトラヒドロビリミジン、ビリミジン、ピペリジ ン、1-ブチルピペリジン、1,2-ジメチルピペリジ ン、1-エチルピペリジン、1-メチルピペリジン、ビ ロリジン、1,2-ジメチルピロリジン、メチルピロリ ジンを挙げることができる。アルキルアミン有機酸およ び環状アミン化合物有機酸の有機酸塩としては、上述の 10 ン性基含有化合物およびハロゲン化合物から選ばれる少 アルキルアミン、環状アミンと有機酸から得られる塩を 挙げることができる。ここで、有機酸としては、酢酸、 プロピオン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘ ブタン酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ 酸、マレイン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシ ン酸、没食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シ キミ酸、2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリ ン酸、リノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香米

15

(R*R*R**R** N), R** R13 (R14) \cdots (5)

(式中、R*~R*は同一または異なり、それぞれ水素 原子、炭素数1~10のアルキル基、ヒドロキシアルキ ル基、アリール基、アリールアルキル基を示し、R¹²は ハロゲン原子、1~4価のアニオン性基を示し、eは1 ~4の整数を示し、R13は窒素原子を含有するg 価の環 状カチオン性基を示し、R¹¹はハロゲン原子、f 価のア ニオン性基を示し、fは1~4の整数、gは1~fの整 数を示し、g・h≤fである。)

上記において炭素数1~10のアルキル基としては、メ などを、アリール基としては、フェニル基、トリル基な どを、アリールアルキル基としては、ベンジル基など を、ハロゲン原子としては塩素原子、臭素原子などを示 す。1~4価のアニオン性基とは、1~4個のアニオン 性基を有する化合物に由来する基であり、窒素原子を含 有するg価の環状カチオン性基とは、g個の窒素原子を 有する芳香族化合物、g個の窒素原子を有する複素環化 合物、g個の窒素原子を有する脂肪族環化合物に由来す る基である。

【0028】一般式(4)で表される化合物としては、 例えば、水酸化アンモニウム、塩化アンモニウム、臭化 アンモニウム、沃化アンモニウム、フッ化アンモニウ ム、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、硫酸水素ア ンモニウム、リン酸アンモニウム、炭酸アンモニウム、 フェノールアンモニウム、酢酸アンモニウム、アジピン 酸アンモニウム、アルギン酸アンモニウム、安息香酸ア ンモニウム、硫酸アンモニウム、クエン酸アンモニウ ム、ギ酸アンモニウム、炭酸水素アンモニウム、フタル 酸アンモニウム、サリチル酸アンモニウム、コハク酸ア

*酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンスルホン酸、ベ ンゼンスルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、ト リクロロ酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、ス ルホン酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸、コ ハク酸、フマル酸、イタコン酸、メサコン酸、シトラコ ン酸、リンゴ酸、グルタル酸などを挙げることができ ・る_

【0027】本発明で使用することのできる窒素オニウ ム塩は、(B-1) 窒素含有化合物と(B-2) アニオ なくとも1種とから形成される塩である。本発明におい て、アニオン性基としては、水酸基、硝酸基、カーボネ ート基、カルボキシル基、スルホニル基、ホスホニル 基、カルボニル基およびフェノキシ基である。窒素オニ ウム塩としては、下記一般式(4)で表される化合物お よび一般式(5)で表される化合物を挙げることができ

. (4)

ンモニウム、ブタン酸アンモニウム、ペンタン酸アンモ ニウム、ヘキサン酸アンモニウム、ヘブタン酸アンモニ ウム、オクタン酸アンモニウム、ノナン酸アンモニウ ム、デカン酸アンモニウム、シュウ酸アンモニウム、メ チルマロン酸アンモニウム、セバシン酸アンモニウム 没食子酸アンモニウム、酪酸アンモニウム、メリット酸 アンモニウム、アラキドン酸アンモニウム、シキミ酸ア ンモニウム、2-エチルヘキサン酸アンモニウム、オレ イン酸アンモニウム、ステアリン酸アンモニウム、リノ チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基 30 ール酸アンモニウム、リノレイン酸アンモニウム、p-アミノ安息香酸アンモニウム、p-トルエンスルホン酸 アンモニウム、ベンゼンスルホン酸アンモニウム、モノ クロロ酢酸アンモニウム、ジクロロ酢酸アンモニウム、 トリクロロ酢酸アンモニウム、トリフルオロ酢酸アンモ ニウム、マロン酸アンモニウム、スルホン酸アンモニウ ム、フマル酸アンモニウム、酒石酸アンモニウム、イタ コン酸アンモニウム、メサコン酸アンモニウム、シトラ コン酸アンモニウム、リンゴ酸アンモニウム、グルタル 酸アンモニウム:水酸化メチルアンモニウム、塩化メチ 40 ルアンモニウム、臭化メチルアンモニウム、沃化メチル アンモニウム、フッ化メチルアンモニウム、硝酸メチル アンモニウム、硫酸メチルアンモニウム、硫酸水素メチ ルアンモニウム、リン酸メチルアンモニウム、炭酸メチ ルアンモニウム、フェノールメチルアンモニウム、酢酸 メチルアンモニウム、アジピン酸メチルアンモニウム、 アルギン酸メチルアンモニウム、安息香酸メチルアンモ ニウム、硫酸メチルアンモニウム、クエン酸メチルアン モニウム、ギ酸メチルアンモニウム、炭酸水素メチルア ンモニウム、フタル酸メチルアンモニウム、サリチル酸 ンモニウム、マレイン酸アンモニウム、プロビオン酸ア 50 メチルアンモニウム、コハク酸メチルアンモニウム、マ

レイン酸メチルアンモニウム、プロピオン酸メチルアン モニウム、ブタン酸メチルアンモニウム、ペンタン酸メ チルアンモニウム、ヘキサン酸メチルアンモニウム、ヘ プタン酸メチルアンモニウム、オクタン酸メチルアンモ ニウム、ノナン酸メチルアンモニウム、デカン酸メチル アンモニウム、シュウ酸メチルアンモニウム、メチルマ ロン酸メチルアンモニウム、セバシン酸メチルアンモニ ウム、没食子酸メチルアンモニウム、酪酸メチルアンモ ニウム、メリット酸メチルアンモニウム、アラキドン酸 メチルアンモニウム、シキミ酸メチルアンモニウム、2 10 チルアンモニウム、シトラコン酸ジメチルアンモニウ - エチルヘキサン酸メチルアンモニウム、オレイン酸メ チルアンモニウム、ステアリン酸メチルアンモニウム、 リノール酸メチルアンモニウム、リノレイン酸メチルア ンモニウム、p-アミノ安息香酸メチルアンモニウム、 p-トルエンスルホン酸メチルアンモニウム、ベンゼン スルホン酸メチルアンモニウム、モノクロロ酢酸メチル アンモニウム、ジクロロ酢酸メチルアンモニウム、トリ クロロ酢酸メチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸メチ ルアンモニウム、マロン酸メチルアンモニウム、スルホ ン酸メチルアンモニウム、フマル酸メチルアンモニウ ム、酒石酸メチルアンモニウム、イタコン酸メチルアン モニウム、メサコン酸メチルアンモニウム、シトラコン 酸メチルアンモニウム、リンゴ酸メチルアンモニウム、 グルタル酸メチルアンモニウム; 水酸化ジメチルアンモ ニウム、塩化ジメチルアンモニウム、臭化ジメチルアン モニウム、沃化ジメチルアンモニウム、フッ化ジメチル アンモニウム、硝酸ジメチルアンモニウム、硫酸ジメチ ルアンモニウム、硫酸水素ジメチルアンモニウム、リン 酸ジメチルアンモニウム、炭酸ジメチルアンモニウム、 フェノールジメチルアンモニウム、酢酸ジメチルアンモ 30 酸トリメチルアンモニウム、ノナン酸トリメチルアンモ ニウム、アジビン酸ジメチルアンモニウム、アルギン酸 ジメチルアンモニウム、安息香酸ジメチルアンモニウ ム、硫酸ジメチルアンモニウム、クエン酸ジメチルアン モニウム、ギ酸ジメチルアンモニウム、炭酸水素ジメチ ルアンモニウム、フタル酸ジメチルアンモニウム、サリ チル酸ジメチルアンモニウム、コハク酸ジメチルアンモ ニウム、マレイン酸ジメチルアンモニウム、プロピオン 酸ジメチルアンモニウム、ブタン酸ジメチルアンモニウ ム、ペンタン酸ジメチルアンモニウム、ヘキサン酸ジメ チルアンモニウム、ヘプタン酸ジメチルアンモニウム、 オクタン酸ジメチルアンモニウム、ノナン酸ジメチルア ンモニウム、デカン酸ジメチルアンモニウム、シュウ酸 ジメチルアンモニウム、メチルマロン酸ジメチルアンモ ニウム、セバシン酸ジメチルアンモニウム、没食子酸ジ メチルアンモニウム、酪酸ジメチルアンモニウム、メリ ット酸ジメチルアンモニウム、アラキドン酸ジメチルア ンモニウム、シキミ酸ジメチルアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸ジメチルアンモニウム、オレイン酸ジメチ ルアンモニウム、ステアリン酸ジメチルアンモニウム、

ルアンモニウム、p-アミノ安息香酸ジメチルアンモニ ウム、p-トルエンスルホン酸ジメチルアンモニウム、 ベンゼンスルホン酸ジメチルアンモニウム、モノクロロ 酢酸ジメチルアンモニウム、ジクロロ酢酸ジメチルアン モニウム、トリクロロ酢酸ジメチルアンモニウム、トリ フルオロ酢酸ジメチルアンモニウム、マロン酸ジメチル アンモニウム、スルホン酸ジメチルアンモニウム、フマ ル酸ジメチルアンモニウム、酒石酸ジメチルアンモニウ ム、イタコン酸ジメチルアンモニウム、メサコン酸ジメ ム、リンゴ酸ジメチルアンモニウム、グルタル酸ジメチ ルアンモニウム:水酸化トリメチルアンモニウム、塩化 トリメチルアンモニウム、臭化トリメチルアンモニウ ム、沃化トリメチルアンモニウム、フッ化トリメチルア ンモニウム、硝酸トリメチルアンモニウム、硫酸トリメ チルアンモニウム、硫酸水素トリメチルアンモニウム、 リン酸トリメチルアンモニウム、炭酸トリメチルアンモ ニウム、フェノールトリメチルアンモニウム、酢酸トリ メチルアンモニウム、アジピン酸トリメチルアンモニウ 20 ム、アルギン酸トリメチルアンモニウム、安息香酸トリ メチルアンモニウム、硫酸トリメチルアンモニウム、ク エン酸トリメチルアンモニウム、ギ酸トリメチルアンモ ニウム、炭酸水素トリメチルアンモニウム、フタル酸ト リメチルアンモニウム、サリチル酸トリメチルアンモニ ウム、コハク酸トリメチルアンモニウム、マレイン酸ト リメチルアンモニウム、プロピオン酸トリメチルアンモ ニウム、ブタン酸トリメチルアンモニウム、ペンタン酸 トリメチルアンモニウム、ヘキサン酸トリメチルアンモ ニウム、ヘプタン酸トリメチルアンモニウム、オクタン ニウム、デカン酸トリメチルアンモニウム、シュウ酸ト リメチルアンモニウム、メチルマロン酸トリメチルアン モニウム、セバシン酸トリメチルアンモニウム、没食子 酸トリメチルアンモニウム、酪酸トリメチルアンモニウ ム、メリット酸トリメチルアンモニウム、アラキドン酸 トリメチルアンモニウム、シキミ酸トリメチルアンモニ ウム、2 – よチルヘキサン酸トリメチルアンモニウム、 オレイン酸トリメチルアンモニウム、ステアリン酸トリ メチルアンモニウム、リノール酸トリメチルアンモニウ 40 ム、リノレイン酸トリメチルアンモニウム、p-アミノ 安息香酸トリメチルアンモニウム、pートルエンスルホ ン酸トリメチルアンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリ メチルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリメチルアンモ ニウム、ジクロロ酢酸トリメチルアンモニウム、トリク ロロ酢酸トリメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸ト リメチルアンモニウム、マロン酸トリメチルアンモニウ ム、スルホン酸トリメチルアンモニウム、フマル酸トリ メチルアンモニウム、酒石酸トリメチルアンモニウム、 イタコン酸トリメチルアンモニウム、メサコン酸トリメ リノール酸ジメチルアンモニウム、リノレイン酸ジメチ 50 チルアンモニウム、シトラコン酸トリメチルアンモニウ

20

ム、リンゴ酸トリメチルアンモニウム、グルタル酸トリ メチルアンモニウム;水酸化エチルアンモニウム、塩化 エチルアンモニウム、臭化エチルアンモニウム、沃化エ チルアンモニウム、フッ化エチルアンモニウム、硝酸エ チルアンモニウム、硫酸エチルアンモニウム、硫酸水素 エチルアンモニウム、リン酸エチルアンモニウム、炭酸 エチルアンモニウム、フェノールエチルアンモニウム、 酢酸エチルアンモニウム、アジピン酸エチルアンモニウ ム、アルギン酸エチルアンモニウム、安息香酸エチルア ンモニウム、硫酸エチルアンモニウム、クエン酸エチル 10 エチルアンモニウム、シキミ酸ジエチルアンモニウム、 アンモニウム、ギ酸エチルアンモニウム、炭酸水素エチ ルアンモニウム、フタル酸エチルアンモニウム、サリチ ル酸エチルアンモニウム、コハク酸エチルアンモニウ ム、マレイン酸エチルアンモニウム、プロピオン酸エチ ルアンモニウム、ブタン酸エチルアンモニウム、ペンタ ン酸エチルアンモニウム、ヘキサン酸エチルアンモニウ ム、ヘプタン酸エチルアンモニウム、オクタン酸エチル アンモニウム、ノナン酸エチルアンモニウム、デカン酸 エチルアンモニウム、シュウ酸エチルアンモニウム、メ チルマロン酸エチルアンモニウム、セバシン酸エチルア 20 ジエチルアンモニウム、スルホン酸ジエチルアンモニウ ンモニウム、没食子酸エチルアンモニウム、酪酸エチル アンモニウム、メリット酸エチルアンモニウム、アラキ ドン酸エチルアンモニウム、シキミ酸エチルアンモニウ ム、2-エチルヘキサン酸エチルアンモニウム、オレイ ン酸エチルアンモニウム、ステアリン酸エチルアンモニ ウム、リノール酸エチルアンモニウム、リノレイン酸エ チルアンモニウム、pーアミノ安息香酸エチルアンモニ ウム、p-トルエンスルホン酸エチルアンモニウム、ベ ンゼンスルホン酸エチルアンモニウム、モノクロロ酢酸 エチルアンモニウム、ジクロロ酢酸エチルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸エチルアンモニウム、トリフルオロ 酢酸エチルアンモニウム、マロン酸エチルアンモニウ ム、スルホン酸エチルアンモニウム、フマル酸エチルア ンモニウム、酒石酸エチルアンモニウム、イタコン酸エ チルアンモニウム、メサコン酸エチルアンモニウム、シ トラコン酸エチルアンモニウム、リンゴ酸エチルアンモ ニウム、グルタル酸エチルアンモニウム; 水酸化ジェチ ルアンモニウム、塩化ジェチルアンモニウム、臭化ジェ チルアンモニウム、沃化ジエチルアンモニウム、フッ化 ジエチルアンモニウム、硝酸ジェチルアンモニウム、硫 40 アンモニウム、ブタン酸トリエチルアンモニウム、ベン 酸ジエチルアンモニウム、硫酸水素ジエチルアンモニウ ム、リン酸ジェチルアンモニウム、炭酸ジェチルアンモ ニウム、フェノールジエチルアンモニウム、酢酸ジエチ ルアンモニウム、アジビン酸ジェチルアンモニウム、ア ルギン酸ジエチルアンモニウム、安息香酸ジェチルアン モニウム、硫酸ジエチルアンモニウム、クエン酸ジェチ ルアンモニウム、ギ酸ジェチルアンモニウム、炭酸水素 ジエチルアンモニウム、フタル酸ジエチルアンモニウ ム、サリチル酸ジエチルアンモニウム、コハク酸ジエチ

ロピオン酸ジエチルアンモニウム、ブタン酸ジエチルア ンモニウム、ペンタン酸ジエチルアンモニウム、ヘキサ ン酸ジエチルアンモニウム、ヘブタン酸ジエチルアンモ ニウム、オクタン酸ジエチルアンモニウム、ノナン酸ジ エチルアンモニウム、デカン酸ジエチルアンモニウム、 シュウ酸ジエチルアンモニウム、メチルマロン酸ジエチ ルアンモニウム、セバシン酸ジエチルアンモニウム、没 食子酸ジェチルアンモニウム、酪酸ジェチルアンモニウ ム、メリット酸ジエチルアンモニウム、アラキドン酸ジ 2-エチルヘキサン酸ジエチルアンモニウム、オレイン 酸ジエチルアンモニウム、ステアリン酸ジエチルアンモ ニウム、リノール酸ジエチルアンモニウム、リノレイン 酸ジエチルアンモニウム、pーアミノ安息香酸ジエチル アンモニウム、p-トルエンスルホン酸ジェチルアンモ ニウム、ベンゼンスルホン酸ジエチルアンモニウム、モ ノクロロ酢酸ジエチルアンモニウム、ジクロロ酢酸ジェ チルアンモニウム、トリクロロ酢酸ジエチルアンモニウ ム、トリフルオロ酢酸ジエチルアンモニウム、マロン酸 ム、フマル酸ジエチルアンモニウム、酒石酸ジエチルア ンモニウム、イタコン酸ジエチルアンモニウム、メサコ ン酸ジエチルアンモニウム、シトラコン酸ジェチルアン モニウム、リンゴ酸ジエチルアンモニウム、グルタル酸 ジエチルアンモニウム:水酸化トリエチルアンモニウ ム、塩化トリエチルアンモニウム、臭化トリエチルアン モニウム、沃化トリエチルアンモニウム、フッ化トリエ チルアンモニウム、硝酸トリエチルアンモニウム、硫酸 トリエチルアンモニウム、硫酸水素トリエチルアンモニ 30 ウム、リン酸トリエチルアンモニウム、炭酸トリエチル アンモニウム、フェノールトリエチルアンモニウム、酢 酸トリエチルアンモニウム、アジビン酸トリエチルアン モニウム、アルギン酸トリエチルアンモニウム、安息香 酸トリエチルアンモニウム、硫酸トリエチルアンモニウ ム、クエン酸トリエチルアンモニウム、ギ酸トリエチル アンモニウム、炭酸水素トリエチルアンモニウム、フタ ル酸トリエチルアンモニウム、サリチル酸トリエチルア ンモニウム、コハク酸トリエチルアンモニウム、マレイ ン酸トリエチルアンモニウム、プロピオン酸トリエチル タン酸トリエチルアンモニウム、ヘキサン酸トリエチル アンモニウム、ヘプタン酸トリエチルアンモニウム、オ クタン酸トリエチルアンモニウム、ノナン酸トリエチル アンモニウム、デカン酸トリエチルアンモニウム、シュ ウ酸トリエチルアンモニウム、メチルマロン酸トリエチ ルアンモニウム、セバシン酸トリエチルアンモニウム、 没食子酸トリエチルアンモニウム、酪酸トリエチルアン モニウム、メリット酸トリエチルアンモニウム、アラキ ドン酸トリエチルアンモニウム、シキミ酸トリエチルア ルアンモニウム、マレイン酸ジェチルアンモニウム、プ 50 ンモニウム、2-エチルヘキサン酸トリェチルアンモニ

ウム、オレイン酸トリエチルアンモニウム、ステアリン 酸トリエチルアンモニウム、リノール酸トリエチルアン モニウム、リノレイン酸トリエチルアンモニウム、p -アミノ安息香酸トリエチルアンモニウム、pートルエン スルホン酸トリエチルアンモニウム、ベンゼンスルホン 酸トリエチルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリエチル アンモニウム、ジクロロ酢酸トリエチルアンモニウム、 トリクロロ酢酸トリエチルアンモニウム、トリフルオロ 酢酸トリエチルアンモニウム、マロン酸トリエチルアン 酸トリエチルアンモニウム、酒石酸トリエチルアンモニ ウム、イタコン酸トリエチルアンモニウム、メサコン酸 トリエチルアンモニウム、シトラコン酸トリエチルアン モニウム、リンゴ酸トリエチルアンモニウム、グルタル 酸トリエチルアンモニウム:水酸化トリプロピルアンモ ニウム、塩化トリプロピルアンモニウム、臭化トリプロ ビルアンモニウム、沃化トリプロビルアンモニウム、フ ッ化トリプロピルアンモニウム、硝酸トリプロピルアン モニウム、硫酸トリプロピルアンモニウム、硫酸水素ト ウム、炭酸トリプロピルアンモニウム、フェノールトリ プロビルアンモニウム、酢酸トリプロビルアンモニウ ム、アジピン酸トリプロピルアンモニウム、アルギン酸 トリプロピルアンモニウム、安息香酸トリプロピルアン モニウム、硫酸トリプロピルアンモニウム、クエン酸ト リプロピルアンモニウム、ギ酸トリプロピルアンモニウ ム、炭酸水素トリプロピルアンモニウム、フタル酸トリ プロビルアンモニウム、サリチル酸トリプロビルアンモ ニウム、コハク酸トリプロピルアンモニウム、マレイン 酸トリプロビルアンモニウム、プロビオン酸トリプロビ 30 ンモニウム、酪酸トリブチルアンモニウム、メリット酸 ルアンモニウム、ブタン酸トリプロビルアンモニウム、 ベンタン酸トリプロピルアンモニウム、ヘキサン酸トリ プロビルアンモニウム、ヘプタン酸トリプロビルアンモ ニウム、オクタン酸トリプロピルアンモニウム、ノナン 酸トリプロピルアンモニウム、デカン酸トリプロピルア ンモニウム、シュウ酸トリプロピルアンモニウム、メチ ルマロン酸トリプロピルアンモニウム、セバシン酸トリ プロピルアンモニウム、没食子酸トリプロピルアンモニ ウム、酪酸トリプロピルアンモニウム、メリット酸トリ プロピルアンモニウム、アラキドン酸トリプロピルアン モニウム、シキミ酸トリプロピルアンモニウム、2-エ チルヘキサン酸トリプロピルアンモニウム、オレイン酸 トリプロピルアンモニウム、ステアリン酸トリプロピル アンモニウム、リノール酸トリプロピルアンモニウム、 リノレイン酸トリプロビルアンモニウム、p-アミノ安 息香酸トリプロビルアンモニウム、p-トルエンスルホ ン酸トリプロピルアンモニウム、ベンゼンスルホン酸ト リプロピルアンモニウム、モノクロロ酢酸トリプロピル アンモニウム、ジクロロ酢酸トリプロピルアンモニウ

ルオロ酢酸トリプロピルアンモニウム、マロン酸トリブ ロピルアンモニウム、スルホン酸トリプロピルアンモニ ウム、フマル酸トリプロピルアンモニウム、酒石酸トリ プロピルアンモニウム、イタコン酸トリプロピルアンモ ニウム、メサコン酸トリプロピルアンモニウム、シトラ コン酸トリプロピルアンモニウム、リンゴ酸トリプロピ ルアンモニウム、グルタル酸トリプロピルアンモニウ ム;水酸化トリプチルアンモニウム、塩化トリプチルア ンモニウム、臭化トリブチルアンモニウム、沃化トリブ モニウム、スルホン酸トリエチルアンモニウム、フマル 10 チルアンモニウム、フッ化トリブチルアンモニウム、硝 酸トリプチルアンモニウム、硫酸トリプチルアンモニウ ム、硫酸水素トリブチルアンモニウム、リン酸トリブチ ルアンモニウム、炭酸トリプチルアンモニウム、フェノ ールトリプチルアンモニウム、酢酸トリプチルアンモニ ウム、アジピン酸トリブチルアンモニウム、アルギン酸 トリブチルアンモニウム、安息香酸トリブチルアンモニ ウム、硫酸トリブチルアンモニウム、クエン酸トリブチ ルアンモニウム、ギ酸トリブチルアンモニウム、炭酸水 素トリプチルアンモニウム、フタル酸トリブチルアンモ リプロビルアンモニウム、リン酸トリプロビルアンモニ 20 ニウム、サリチル酸トリブチルアンモニウム、コハク酸 トリブチルアンモニウム、マレイン酸トリブチルアンモ ニウム、プロピオン酸トリブチルアンモニウム、ブタン 酸トリブチルアンモニウム、ペンタン酸トリブチルアン モニウム、ヘキサン酸トリブチルアンモニウム、ヘプタ ン酸トリブチルアンモニウム、オクタン酸トリブチルア ンモニウム、ノナン酸トリブチルアンモニウム、デカン 酸トリプチルアンモニウム、シュウ酸トリブチルアンモ ニウム、メチルマロン酸トリブチルアンモニウム、セバ シン酸トリブチルアンモニウム、没食子酸トリブチルア トリブチルアンモニウム、アラキドン酸トリブチルアン モニウム、シキミ酸トリブチルアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸トリブチルアンモニウム、オレイン酸トリ ブチルアンモニウム、ステアリン酸トリブチルアンモニ ウム、リノール酸トリブチルアンモニウム、リノレイン 酸トリプチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸トリブ チルアンモニウム、p-トルエンスルホン酸トリブチル アンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリブチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸トリブチルアンモニウム、ジクロ 口酢酸トリブチルアンモニウム、トリクロロ酢酸トリブ チルアンモニウム、トリフルオロ酢酸トリブチルアンモ ニウム、マロン酸トリブチルアンモニウム、スルホン酸 トリプチルアンモニウム、フマル酸トリプチルアンモニ ウム、酒石酸トリブチルアンモニウム、イタコン酸トリ ブチルアンモニウム、メサコン酸トリブチルアンモニウ ム、シトラコン酸トリブチルアンモニウム、リンゴ酸ト リブチルアンモニウム、グルタル酸トリブチルアンモニ ウム;水酸化テトラメチルアンモニウム、塩化テトラメ チルアンモニウム、臭化テトラメチルアンモニウム、沃 ム、トリクロロ酢酸トリプロビルアンモニウム、トリフ 50 化テトラメチルアンモニウム、フッ化テトラメチルアン

23 モニウム、硝酸テトラメチルアンモニウム、硫酸テトラ メチルアンモニウム、硫酸水素テトラメチルアンモニウ ム、リン酸テトラメチルアンモニウム、炭酸テトラメチ ルアンモニウム、フェノールテトラメチルアンモニウ ム、酢酸テトラメチルアンモニウム、アジビン酸テトラ メチルアンモニウム、アルギン酸テトラメチルアンモニ ウム、安息香酸テトラメチルアンモニウム、硫酸テトラ メチルアンモニウム、クエン酸テトラメチルアンモニウ ム、ギ酸テトラメチルアンモニウム、炭酸水素テトラメ チルアンモニウム、フタル酸テトラメチルアンモニウ ム、サリチル酸テトラメチルアンモニウム、コハク酸テ トラメチルアンモニウム、マレイン酸テトラメチルアン モニウム、プロピオン酸テトラメチルアンモニウム、ブ タン酸テトラメチルアンモニウム、ペンタン酸テトラメ チルアンモニウム、ヘキサン酸テトラメチルアンモニウ ム、ヘプタン酸テトラメチルアンモニウム、オクタン酸 テトラメチルアンモニウム、ノナン酸テトラメチルアン モニウム、デカン酸テトラメチルアンモニウム、シュウ 酸テトラメチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラメ チルアンモニウム、セバシン酸テトラメチルアンモニウ 20 モニウム、リノレイン酸テトラエチルアンモニウム、p ム、没食子酸テトラメチルアンモニウム、酪酸テトラメ チルアンモニウム、メリット酸テトラメチルアンモニウ ム、アラキドン酸テトラメチルアンモニウム、シキミ酸 テトラメチルアンモニウム、2-エチルヘキサン酸テト ラメチルアンモニウム、オレイン酸テトラメチルアンモ ニウム、ステアリン酸テトラメチルアンモニウム、リノ ール酸テトラメチルアンモニウム、リノレイン酸テトラ メチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸テトラメチル アンモニウム、p-トルエンスルホン酸テトラメチルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸テトラメチルアンモニ 30 チルアンモニウム、メサコン酸テトラエチルアンモニウ ウム、モノクロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラメチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テ トラメチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラメチ ルアンモニウム、マロン酸テトラメチルアンモニウム、 スルホン酸テトラメチルアンモニウム、フマル酸テトラ メチルアンモニウム、酒石酸テトラメチルアンモニウ ム、イタコン酸テトラメチルアンモニウム、メサコン酸 テトラメチルアンモニウム、シトラコン酸テトラメチル アンモニウム、リンゴ酸テトラメチルアンモニウム、グ ルタル酸テトラメチルアンモニウム;水酸化テトラエチ 40 ルテトラプロピルアンモニウム、酢酸テトラプロピルア ルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化 テトラエチルアンモニウム、沃化テトラエチルアンモニ ウム、フッ化テトラエチルアンモニウム、硝酸テトラエ チルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウム、硫 酸水素テトラエチルアンモニウム、リン酸テトラエチル アンモニウム、炭酸テトラエチルアンモニウム、フェノ ールテトラエチルアンモニウム、酢酸テトラエチルアン モニウム、アジピン酸テトラエチルアンモニウム、アル ギン酸テトラエチルアンモニウム、安息香酸テトラエチ

ン酸テトラエチルアンモニウム、ギ酸テトラエチルアン モニウム、炭酸水素テトラエチルアンモニウム、フタル 酸テトラエチルアンモニウム、サリチル酸テトラエチル アンモニウム、コハク酸テトラエチルアンモニウム、マ レイン酸テトラエチルアンモニウム、プロピオン酸テト ラエチルアンモニウム、ブタン酸テトラエチルアンモニ ウム、ペンタン酸テトラエチルアンモニウム、ヘキサン 酸テトラエチルアンモニウム、ヘプタン酸テトラエチル アンモニウム、オクタン酸テトラエチルアンモニウム、 10 ノナン酸テトラエチルアンモニウム、デカン酸テトラエ チルアンモニウム、シュウ酸テトラエチルアンモニウ ム、メチルマロン酸テトラエチルアンモニウム、セバシ ン酸テトラエチルアンモニウム、没食子酸テトラエチル アンモニウム、酩酸テトラエチルアンモニウム、メリッ ト酸テトラエチルアンモニウム、アラキドン酸テトラエ チルアンモニウム、シキミ酸テトラエチルアンモニウ ム、2-エチルヘキサン酸テトラエチルアンモニウム、 オレイン酸テトラエチルアンモニウム、ステアリン酸テ トラエチルアンモニウム、リノール酸テトラエチルアン -アミノ安息香酸テトラエチルアンモニウム、p-トル エンスルホン酸テトラエチルアンモニウム、ベンゼンス ルホン酸テトラエチルアンモニウム、モノクロロ酢酸テ トラエチルアンモニウム、ジクロロ酢酸テトラエチルア ンモニウム、トリクロロ酢酸テトラエチルアンモニウ ム、トリフルオロ酢酸テトラエチルアンモニウム、マロ ン酸テトラエチルアンモニウム、スルホン酸テトラエチ ルアンモニウム、フマル酸テトラエチルアンモニウム 酒石酸テトラエチルアンモニウム、イタコン酸テトラエ ム、シトラコン酸テトラエチルアンモニウム、リンゴ酸 テトラエチルアンモニウム、グルタル酸テトラエチルア ンモニウム:水酸化テトラプロビルアンモニウム、塩化 テトラプロピルアンモニウム、臭化テトラプロピルアン モニウム、沃化テトラプロピルアンモニウム、フッ化テ トラプロピルアンモニウム、硝酸テトラプロピルアンモ ニウム、硫酸テトラプロビルアンモニウム、硫酸水素テ トラプロピルアンモニウム、リン酸テトラプロビルアン モニウム、炭酸テトラプロビルアンモニウム、フェノー ンモニウム、アジビン酸テトラプロピルアンモニウム、 アルギン酸テトラプロピルアンモニウム、安息香酸テト ラプロピルアンモニウム、硫酸テトラプロビルアンモニ ウム、クエン酸テトラプロビルアンモニウム、ギ酸テト ラプロピルアンモニウム、炭酸水素テトラプロピルアン モニウム、フタル酸テトラプロビルアンモニウム、サリ チル酸テトラプロビルアンモニウム、コハク酸テトラブ ロビルアンモニウム、マレイン酸テトラプロビルアンモ ニウム、プロピオン酸テトラプロビルアンモニウム、ブ ルアンモニウム、硫酸テトラエチルアンモニウム、クエ 50 タン酸テトラプロビルアンモニウム、ベンタン酸テトラ

(14)

プロピルアンモニウム、ヘキサン酸テトラプロピルアン モニウム、ヘブタン酸テトラプロビルアンモニウム、オ クタン酸テトラプロビルアンモニウム、ノナン酸テトラ プロビルアンモニウム、デカン酸テトラプロビルアンモ ニウム、シュウ酸テトラプロピルアンモニウム、メチル マロン酸テトラプロピルアンモニウム、セバシン酸テト ラプロピルアンモニウム、没食子酸テトラプロピルアン モニウム、酪酸テトラプロビルアンモニウム、メリット 酸テトラプロピルアンモニウム、アラキドン酸テトラブ ロビルアンモニウム、シキミ酸テトラプロビルアンモニ 10 ウム、2-エチルヘキサン酸テトラプロピルアンモニウ ム、オレイン酸テトラプロピルアンモニウム、ステアリ ン酸テトラプロピルアンモニウム、リノール酸テトラブ ロビルアンモニウム、リノレイン酸テトラプロビルアン モニウム、p-アミノ安息香酸テトラプロビルアンモニ ウム、p-トルエンスルホン酸テトラプロビルアンモニ ウム、ベンゼンスルホン酸テトラプロピルアンモニウ ム、モノクロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラプロピルアンモニウム、トリクロロ酢酸 プロピルアンモニウム、マロン酸テトラプロピルアンモ ニウム、スルホン酸テトラプロビルアンモニウム、フマ ル酸テトラプロピルアンモニウム、酒石酸テトラプロピ ルアンモニウム、イタコン酸テトラプロビルアンモニウ ム、メサコン酸テトラプロピルアンモニウム、シトラコ ン酸テトラプロピルアンモニウム、リンゴ酸テトラプロ ピルアンモニウム、グルタル酸テトラプロピルアンモニ ウム:水酸化テトラブチルアンモニウム、塩化テトラブ チルアンモニウム、臭化テトラブチルアンモニウム、沃 モニウム、硝酸テトラブチルアンモニウム、硫酸テトラ ブチルアンモニウム、硫酸水素テトラブチルアンモニウ ム、リン酸テトラブチルアンモニウム、炭酸テトラブチ ルアンモニウム、フェノールテトラブチルアンモニウ ム、酢酸テトラブチルアンモニウム、アジピン酸テトラ ブチルアンモニウム、アルギン酸テトラブチルアンモニ ウム、安息香酸テトラブチルアンモニウム、硫酸テトラ ブチルアンモニウム、クエン酸テトラブチルアンモニウ ム、ギ酸テトラブチルアンモニウム、炭酸水素テトラブ チルアンモニウム、フタル酸テトラブチルアンモニウ ム、サリチル酸テトラブチルアンモニウム、コハク酸テ トラブチルアンモニウム、マレイン酸テトラブチルアン モニウム、プロピオン酸テトラブチルアンモニウム、ブ タン酸テトラブチルアンモニウム、ペンタン酸テトラブ チルアンモニウム、ヘキサン酸テトラブチルアンモニウ ム、ヘプタン酸テトラブチルアンモニウム、オクタン酸 テトラブチルアンモニウム、ノナン酸テトラブチルアン モニウム、デカン酸テトラブチルアンモニウム、シュウ 酸テトラブチルアンモニウム、メチルマロン酸テトラブ

ム、没食子酸テトラブチルアンモニウム、酪酸テトラブ チルアンモニウム、メリット酸テトラブチルアンモニウ ム、アラキドン酸テトラブチルアンモニウム、シキミ酸 テトラブチルアンモニウム、2-エチルヘキサン酸テト ラブチルアンモニウム、オレイン酸テトラブチルアンモ ニウム、ステアリン酸テトラブチルアンモニウム、リノ ール酸テトラブチルアンモニウム、リノレイン酸テトラ ブチルアンモニウム、p-アミノ安息香酸テトラブチル アンモニウム、p-トルエンスルホン酸テトラブチルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸テトラブチルアンモニ ウム、モノクロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、ジク ロロ酢酸テトラブチルアンモニウム、トリクロロ酢酸テ トラブチルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラブチ ルアンモニウム、マロン酸テトラブチルアンモニウム、 スルホン酸テトラブチルアンモニウム、フマル酸テトラ ブチルアンモニウム、酒石酸テトラブチルアンモニウ ム、イタコン酸テトラブチルアンモニウム、メサコン酸 テトラブチルアンモニウム、シトラコン酸テトラブチル アンモニウム、リンゴ酸テトラブチルアンモニウム、グ テトラプロピルアンモニウム、トリフルオロ酢酸テトラ 20 ルタル酸テトラブチルアンモニウム:水酸化トリメチル ベンジルアンモニウム、塩化トリメチルベンジルアンモ ニウム、臭化トリメチルベンジルアンモニウム、沃化ト リメチルベンジルアンモニウム、フッ化トリメチルベン ジルアンモニウム、硝酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、硫酸トリメチルベンジルアンモニウム、硫酸水素ト リメチルベンジルアンモニウム、リン酸トリメチルベン ジルアンモニウム、炭酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、フェノールトリメチルベンジルアンモニウム、酢酸 トリメチルベンジルアンモニウム、アジピン酸トリメチ 化テトラブチルアンモニウム、フッ化テトラブチルアン 30 ルベンジルアンモニウム、アルギン酸トリメチルベンジ ルアンモニウム、安息香酸トリメチルベンジルアンモニ ウム、硫酸トリメチルベンジルアンモニウム、クエン酸 トリメチルベンジルアンモニウム、ギ酸トリメチルベン ジルアンモニウム、炭酸水素トリメチルベンジルアンモ ニウム、フタル酸トリメチルベンジルアンモニウム、サ リチル酸トリメチルベンジルアンモニウム、コハク酸ト リメチルベンジルアンモニウム、マレイン酸トリメチル ベンジルアンモニウム、プロピオン酸トリメチルベンジ ルアンモニウム、ブタン酸トリメチルベンジルアンモニ 40 ウム、ペンタン酸トリメチルベンジルアンモニウム、ヘ キサン酸トリメチルベンジルアンモニウム、ヘプタン酸 トリメチルベンジルアンモニウム、オクタン酸トリメチ ルベンジルアンモニウム、ノナン酸トリメチルベンジル アンモニウム、デカン酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、シュウ酸トリメチルベンジルアンモニウム、メチル マロン酸トリメチルベンジルアンモニウム、セバシン酸 トリメチルベンジルアンモニウム、没食子酸トリメチル ベンジルアンモニウム、酪酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、メリット酸トリメチルベンジルアンモニウム、 チルアンモニウム、セバシン酸テトラブチルアンモニウ 50 アラキドン酸トリメチルベンジルアンモニウム、シキミ

28

酸トリメチルベンジルアンモニウム、2-エチルヘキサ ン酸トリメチルベンジルアンモニウム、オレイン酸トリ メチルベンジルアンモニウム、ステアリン酸トリメチル ベンジルアンモニウム、リノール酸トリメチルベンジル アンモニウム、リノレイン酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、p-アミノ安息香酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、p-トルエンスルホン酸トリメチルベンジルア ンモニウム、ベンゼンスルホン酸トリメチルベンジルア ンモニウム、モノクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、ジクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウ ム、トリクロロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウム、 トリフルオロ酢酸トリメチルベンジルアンモニウム、マ ロン酸トリメチルベンジルアンモニウム、スルホン酸ト リメチルベンジルアンモニウム、フマル酸トリメチルベ ンジルアンモニウム、酒石酸トリメチルベンジルアンモ ニウム、イタコン酸トリメチルベンジルアンモニウム、 メサコン酸トリメチルベンジルアンモニウム、シトラコ ン酸トリメチルベンジルアンモニウム、リンゴ酸トリメ チルベンジルアンモニウム、グルタル酸トリメチルベン ジルアンモニウム:

27

【0029】水酸化エタノールアンモニウム、塩化エタ ノールアンモニウム、臭化エタノールアンモニウム、沃 化エタノールアンモニウム、フッ化エタノールアンモニ ウム、硝酸エタノールアンモニウム、硫酸エタノールア ンモニウム、硫酸水素エタノールアンモニウム、リン酸 エタノールアンモニウム、炭酸エタノールアンモニウ ム、フェノールエタノールアンモニウム、酢酸エタノー ルアンモニウム、アジピン酸エタノールアンモニウム、 アルギン酸エタノールアンモニウム、安息香酸エタノー 酸エタノールアンモニウム、ギ酸エタノールアンモニウ ム、炭酸水素エタノールアンモニウム、フタル酸エタノ ールアンモニウム、サリチル酸エタノールアンモニウ ム、コハク酸エタノールアンモニウム、マレイン酸エタ ノールアンモニウム、プロピオン酸エタノールアンモニ ウム、ブタン酸エタノールアンモニウム、ペンタン酸エ タノールアンモニウム、ヘキサン酸エタノールアンモニ ウム、ヘプタン酸エタノールアンモニウム、オクタン酸 エタノールアンモニウム、ノナン酸エタノールアンモニ ウム、デカン酸エタノールアンモニウム、シュウ酸エタ 40 ノールアンモニウム、メチルマロン酸エタノールアンモ ニウム、セバシン酸エタノールアンモニウム、没食子酸 エタノールアンモニウム、酪酸エタノールアンモニウ ム、メリット酸エタノールアンモニウム、アラキドン酸 エタノールアンモニウム、シキミ酸エタノールアンモニ ウム、2-エチルヘキサン酸エタノールアンモニウム、 オレイン酸エタノールアンモニウム、ステアリン酸エタ ノールアンモニウム、リノール酸エタノールアンモニウ ム、リノレイン酸エタノールアンモニウム、p-アミノ

ン酸エタノールアンモニウム、ベンゼンスルホン酸エタ ノールアンモニウム、モノクロロ酢酸エタノールアンモ ニウム、ジクロロ酢酸エタノールアンモニウム、トリク ロロ酢酸エタノールアンモニウム、トリフルオロ酢酸エ タノールアンモニウム、マロン酸エタノールアンモニウ ム、スルホン酸エタノールアンモニウム、フマル酸エタ ノールアンモニウム、酒石酸エタノールアンモニウム、 イタコン酸エタノールアンモニウム、メサコン酸エタノ ールアンモニウム、シトラコン酸エタノールアンモニウ 10 ム、リンゴ酸エタノールアンモニウム、グルタル酸エタ ノールアンモニウム:水酸化ジエタノールアンモニウ ム、塩化ジエタノールアンモニウム、臭化ジエタノール アンモニウム、沃化ジエタノールアンモニウム、フッ化 ジエタノールアンモニウム、硝酸ジエタノールアンモニ ウム、硫酸ジエタノールアンモニウム、硫酸水素ジエタ ノールアンモニウム、リン酸ジエタノールアンモニウ ム、炭酸ジエタノールアンモニウム、フェノールジエタ ノールアンモニウム、酢酸ジエタノールアンモニウム、 アジピン酸ジエタノールアンモニウム、アルギン酸ジェ 20 タノールアンモニウム、安息香酸ジェタノールアンモニ ウム、硫酸ジエタノールアンモニウム、クエン酸ジエタ ノールアンモニウム、ギ酸ジエタノールアンモニウム、 炭酸水素ジエタノールアンモニウム、フタル酸ジエタノ ールアンモニウム、サリチル酸ジエタノールアンモニウ ム、コハク酸ジエタノールアンモニウム、マレイン酸ジ エタノールアンモニウム、プロピオン酸ジエタノールア ンモニウム、ブタン酸ジエタノールアンモニウム、ペン タン酸ジエタノールアンモニウム、ヘキサン酸ジェタノ ールアンモニウム、ヘプタン酸ジエタノールアンモニウ ルアンモニウム、硫酸エタノールアンモニウム、クエン 30 ム、オクタン酸ジエタノールアンモニウム、ノナン酸ジ エタノールアンモニウム、デカン酸ジエタノールアンモ ニウム、シュウ酸ジエタノールアンモニウム、メチルマ ロン酸ジエタノールアンモニウム、セバシン酸ジエタノ ールアンモニウム、没食子酸ジエタノールアンモニウ ム、酪酸ジエタノールアンモニウム、メリット酸ジエタ ノールアンモニウム、アラキドン酸ジエタノールアンモ ニウム、シキミ酸ジエタノールアンモニウム、2-エチ ルヘキサン酸ジエタノールアンモニウム、オレイン酸ジ エタノールアンモニウム、ステアリン酸ジエタノールア ンモニウム、リノール酸ジエタノールアンモニウム、リ ノレイン酸ジエタノールアンモニウム、p-アミノ安息 香酸ジエタノールアンモニウム、p-トルエンスルホン 酸ジエタノールアンモニウム、ベンゼンスルホン酸ジェ タノールアンモニウム、モノクロロ酢酸ジエタノールア ンモニウム、ジクロロ酢酸ジエタノールアンモニウム、 トリクロロ酢酸ジエタノールアンモニウム、トリフルオ 口酢酸ジエタノールアンモニウム、マロン酸ジエタノー ルアンモニウム、スルホン酸ジェタノールアンモニウ ム、フマル酸ジエタノールアンモニウム、酒石酸ジエタ 安息香酸エタノールアンモニウム、p -トルエンスルホ 50 ノールアンモニウム、イタコン酸ジエタノールアンモニ

ウム、メサコン酸ジエタノールアンモニウム、シトラコ ン酸ジエタノールアンモニウム、リンゴ酸ジェタノール アンモニウム、グルタル酸ジエタノールアンモニウム; 水酸化トリエタノールアンモニウム、塩化トリエタノー ルアンモニウム、臭化トリエタノールアンモニウム、沃 化トリエタノールアンモニウム、フッ化トリエタノール アンモニウム、硝酸トリエタノールアンモニウム、硫酸 トリエタノールアンモニウム、硫酸水素トリエタノール アンモニウム、リン酸トリエタノールアンモニウム、炭 ールアンモニウム、酢酸トリエタノールアンモニウム、 アジピン酸トリエタノールアンモニウム、アルギン酸ト リエタノールアンモニウム、安息香酸トリエタノールア ンモニウム、硫酸トリエタノールアンモニウム、クエン 酸トリエタノールアンモニウム、ギ酸トリエタノールア ンモニウム、炭酸水素トリエタノールアンモニウム、フ タル酸トリエタノールアンモニウム、サリチル酸トリエ タノールアンモニウム、コハク酸トリエタノールアンモ ニウム、マレイン酸トリエタノールアンモニウム、プロ タノールアンモニウム、ペンタン酸トリエタノールアン モニウム、ヘキサン酸トリエタノールアンモニウム、ヘ プタン酸トリエタノールアンモニウム、オクタン酸トリ エタノールアンモニウム、ノナン酸トリエタノールアン モニウム、デカン酸トリエタノールアンモニウム、シュ ウ酸トリエタノールアンモニウム、メチルマロン酸トリ エタノールアンモニウム、セバシン酸トリエタノールア ンモニウム、没食子酸トリエタノールアンモニウム、酪 酸トリエタノールアンモニウム、メリット酸トリエタノ ニウム、シキミ酸トリエタノールアンモニウム、2-エ チルヘキサン酸トリエタノールアンモニウム、オレイン 酸トリエタノールアンモニウム、ステアリン酸トリエタ ノールアンモニウム、リノール酸トリエタノールアンモ ニウム、リノレイン酸トリエタノールアンモニウム、p -アミノ安息香酸トリエタノールアンモニウム、p-ト ルエンスルホン酸トリエタノールアンモニウム、ベンゼ ンスルホン酸トリエタノールアンモニウム、モノクロロ 酢酸トリエタノールアンモニウム、ジクロロ酢酸トリエ タノールアンモニウム、トリクロロ酢酸トリエタノール 40 アンモニウム、トリフルオロ酢酸トリエタノールアンモ ニウム、マロン酸トリエタノールアンモニウム、スルホ ン酸トリエタノールアンモニウム、フマル酸トリエタノ ールアンモニウム、酒石酸トリエタノールアンモニウ ム、イタコン酸トリエタノールアンモニウム、メサコン 酸トリエタノールアンモニウム、シトラコン酸トリエタ ノールアンモニウム、リンゴ酸トリエタノールアンモニ ウム、グルタル酸トリエタノールアンモニウム;一般式 (5)で表される化合物としては、水酸化ピリジニウ

ニウム、フッ化ピリジニウム、硝酸ピリジニウム、硫酸 ピリジニウム、硫酸水素ピリジニウム、リン酸ピリジニ ウム、炭酸ピリジニウム、フェノールピリジニウム、酢 酸ピリジニウム、アジピン酸ピリジニウム、アルギン酸 ピリジニウム、安息香酸ピリジニウム、硫酸ピリジニウ ム、クエン酸ピリジニウム、ギ酸ピリジニウム、炭酸水 素ピリジニウム、フタル酸ピリジニウム、サリチル酸ピ リジニウム、コハク酸ピリジニウム、マレイン酸ピリジ ニウム、プロピオン酸ピリジニウム、ブタン酸ピリジニ 酸トリエタノールアンモニウム、フェノールトリエタノ 10 ウム、ペンタン酸ビリジニウム、ヘキサン酸ビリジニウ ム、ヘプタン酸ピリジニウム、オクタン酸ピリジニウ ム、ノナン酸ピリジニウム、デカン酸ピリジニウム、シ ュウ酸ピリジニウム、メチルマロン酸ピリジニウム、セ バシン酸ピリジニウム、没食子酸ピリジニウム、酪酸ピ リジニウム、メリット酸ピリジニウム、アラキドン酸ビ リジニウム、シキミ酸ピリジニウム、2-エチルヘキサ ン酸ピリジニウム、オレイン酸ピリジニウム、ステアリ ン酸ピリジニウム、リノール酸ピリジニウム、リノレイ ン酸ビリジニウム、p-アミノ安息香酸ビリジニウム、 ピオン酸トリエタノールアンモニウム、ブタン酸トリエ 20 p-トルエンスルホン酸ピリジニウム、ベンゼンスルホ ン酸ピリジニウム、モノクロロ酢酸ピリジニウム、ジク ロロ酢酸ピリジニウム、トリクロロ酢酸ピリジニウム、 トリフルオロ酢酸ビリジニウム、マロン酸ビリジニウ ム、スルホン酸ピリジニウム、フマル酸ピリジニウム、 酒石酸ピリジニウム、イタコン酸ピリジニウム、メサコ ン酸ピリジニウム、シトラコン酸ピリジニウム、リンゴ 酸ピリジニウム、グルタル酸ピリジニウム;水酸化キノ リニウム、塩化キノリニウム、臭化キノリニウム、沃化 キノリニウム、フッ化キノリニウム、硝酸キノリニウ ールアンモニウム、アラキドン酸トリエタノールアンモ 30 ム、硫酸キノリニウム、硫酸水素キノリニウム、リン酸 キノリニウム、炭酸キノリニウム、フェノールキノリニ ウム、酢酸キノリニウム、アジピン酸キノリニウム、ア ルギン酸キノリニウム、安息香酸キノリニウム、硫酸キ ノリニウム、クエン酸キノリニウム、ギ酸キノリニウ ム、炭酸水素キノリニウム、フタル酸キノリニウム、サ ・リチル酸キノリニウム、コハク酸キノリニウム、マレイ ン酸キノリニウム、プロピオン酸キノリニウム、ブタン・ 酸キノリニウム、ペンタン酸キノリニウム、ヘキサン酸 キノリニウム、ヘプタン酸キノリニウム、オクタン酸キ ノリニウム、ノナン酸キノリニウム、デカン酸キノリニ ウム、シュウ酸キノリニウム、メチルマロン酸キノリニ ウム、セバシン酸キノリニウム、没食子酸キノリニウ ム、酪酸キノリニウム、メリット酸キノリニウム、アラ キドン酸キノリニウム、シキミ酸キノリニウム、2-エ チルヘキサン酸キノリニウム、オレイン酸キノリニウ ム、ステアリン酸キノリニウム、リノール酸キノリニウ ム、リノレイン酸キノリニウム、p-アミノ安息香酸キ ノリニウム、p-トルエンスルホン酸キノリニウム、ベ ンゼンスルホン酸キノリニウム、モノクロロ酢酸キノリ ム、塩化ピリジニウム、臭化ピリジニウム、沃化ピリジ 50 ニウム、ジクロロ酢酸キノリニウム、トリクロロ酢酸キ

32

ノリニウム、トリフルオロ酢酸キノリニウム、マロン酸 キノリニウム、スルホン酸キノリニウム、フマル酸キノ リニウム、酒石酸キノリニウム、イタコン酸キノリニウ ム、メサコン酸キノリニウム、シトラコン酸キノリニウ ム、リンゴ酸キノリニウム、グルタル酸キノリニウム: 水酸化ピペリジニウム、塩化ピペリジニウム、臭化ピペ リジニウム、沃化ピペリジニウム、フッ化ピペリジニウ ム、硝酸ピペリジニウム、硫酸ピペリジニウム、硫酸水 素ピペリジニウム、リン酸ピペリジニウム、炭酸ピペリ ウム、アジピン酸ピペリジニウム、アルギン酸ピペリジ ニウム、安息香酸ピペリジニウム、硫酸ピペリジニウ ム、クエン酸ピペリジニウム、ギ酸ピペリジニウム、炭 酸水素ピペリジニウム、フタル酸ピペリジニウム、サリ チル酸ピペリジニウム、コハク酸ピペリジニウム、マレ イン酸ピペリジニウム、プロピオン酸ピペリジニウム、 ブタン酸ピペリジニウム、ペンタン酸ピペリジニウム、 ヘキサン酸ピペリジニウム、ヘブタン酸ピペリジニウ ム、オクタン酸ピペリジニウム、ノナン酸ピペリジニウ ム、デカン酸ビベリジニウム、シュウ酸ビベリジニウ ム、メチルマロン酸ピペリジニウム、セバシン酸ピペリ ジニウム、没食子酸ピペリジニウム、酪酸ピペリジニウ ム、メリット酸ピペリジニウム、アラキドン酸ピペリジ ニウム、シキミ酸ピペリジニウム、2-エチルヘキサン 酸ピペリジニウム、オレイン酸ピペリジニウム、ステア リン酸ピペリジニウム、リノール酸ピペリジニウム、リ ノレイン酸ビベリジニウム、p-アミノ安息香酸ビベリ ジニウム、p-トルエンスルホン酸ピペリジニウム、ベ ンゼンスルホン酸ビベリジニウム、モノクロロ酢酸ビベ 酢酸ピペリジニウム、トリフルオロ酢酸ピペリジニウ ム、マロン酸ピペリジニウム、スルホン酸ピペリジニウ ム、フマル酸ピペリジニウム、酒石酸ピペリジニウム、 イタコン酸ピペリジニウム、メサコン酸ピペリジニウ ム、シトラコン酸ピペリジニウム、リンゴ酸ピペリジニ ウム、グルタル酸ピペリジニウム:水酸化ピペラジニウ ム、塩化ビベラジニウム、臭化ビベラジニウム、沃化ビ ペラジニウム、フッ化ピペラジニウム、硝酸ピペラジニ ウム、硫酸ピペラジニウム、硫酸水素ピペラジニウム ルピペラジニウム、酢酸ピペラジニウム、アジピン酸ピ ベラジニウム、アルギン酸ビベラジニウム、安息香酸ビ ベラジニウム、硫酸ピペラジニウム、クエン酸ピペラジ ニウム、ギ酸ピペラジニウム、炭酸水素ピペラジニウ ム、フタル酸ピペラジニウム、サリチル酸ピペラジニウ ム、コハク酸ピペラジニウム、マレイン酸ピペラジニウ ム、プロピオン酸ピペラジニウム、ブタン酸ピペラジニ ウム、ペンタン酸ピペラジニウム、ヘキサン酸ピペラジ ニウム、ヘブタン酸ピペラジニウム、オクタン酸ピペラ

ニウム、シュウ酸ビベラジニウム、メチルマロン酸ビベ ラジニウム、セバシン酸ピペラジニウム、没食子酸ピペ ラジニウム、酪酸ピペラジニウム、メリット酸ピペラジ ニウム、アラキドン酸ピペラジニウム、シキミ酸ピペラ ジニウム、2-エチルヘキサン酸ピペラジニウム、オレ イン酸ピペラジニウム、ステアリン酸ピペラジニウム、 リノール酸ピペラジニウム、リノレイン酸ピペラジニウ ム、p-アミノ安息香酸ピペラジニウム、p-トルエン スルホン酸ピペラジニウム、ベンゼンスルホン酸ピペラ ジニウム、フェノールピペリジニウム、酢酸ピペリジニ 10 ジニウム、モノクロロ酢酸ピペラジニウム、ジクロロ酢 酸ピペラジニウム、トリクロロ酢酸ピペラジニウム、ト リフルオロ酢酸ピペラジニウム、マロン酸ピペラジニウ ム、スルホン酸ピペラジニウム、フマル酸ピペラジニウ ム、酒石酸ビペラジニウム、イタコン酸ビベラジニウ ム、メサコン酸ピペラジニウム、シトラコン酸ピペラジ ニウム、リンゴ酸ピペラジニウム、グルタル酸ピペラジ ニウム:ジアザビシクロオクタン塩酸塩、ジアザビシク ロオクタン臭酸塩、ジアザビシクロオクタン硝酸塩、ジ アザビシクロオクタン硫酸塩、ジアザビシクロオクタン 20 硫酸水素塩、ジアザビシクロオクタン炭酸塩、ジアザビ シクロオクタン炭酸水素塩、ジアザビシクロオクタン酢 酸塩、ジアザビシクロオクタンマレイン酸塩、ジアザビ シクロオクタンフタル酸塩、ジアザビシクロオクタンシ ュウ酸塩、ジアザビシクロオクタンイタコン酸塩、ジア ザビシクロオクタンマロン酸塩、ジアザビシクロオクタ ンギ酸塩、ジアザビシクロオクタン酪酸塩、ジアザビシ クロオクタンリンゴ酸塩、ジアザビシクロノナン塩酸 塩、ジアザビシクロノナン臭酸塩、ジアザビシクロノナ ン硝酸塩、ジアザビシクロノナン硫酸塩、ジアザビシク リジニウム、ジクロロ酢酸ピペリジニウム、トリクロロ 30 ロノナン硫酸水素塩、ジアザビシクロノナン炭酸塩、ジ アザビシクロノナン炭酸水素塩、ジアザビシクロノナン 酢酸塩、ジアザビシクロノナンマレイン酸塩、ジアザビ シクロノナンフタル酸塩、ジアザビシクロノナンシュウ 酸塩、ジアザビシクロノナンイタコン酸塩、ジアザビシ クロノナンマロン酸塩、ジアザビシクロノナンギ酸塩 ジアザビシクロノナン酪酸塩、ジアザビシクロノナンリ ンゴ酸塩、ジアザビシクロウンデセン塩酸塩、ジアザビ シクロウンデセン臭酸塩、ジアザビシクロウンデセン硝 酸塩、ジアザビシクロウンデセン硫酸塩、ジアザビシク リン酸ビベラジニウム、炭酸ビベラジニウム、フェノー 40 ロウンデセン硫酸水素塩、ジアザビシクロウンデセン炭 酸塩、ジアザビシクロウンデセン炭酸水素塩、ジアザビ シクロウンデセン酢酸塩、ジアザビシクロウンデセンマ レイン酸塩、ジアザビシクロウンデセンフタル酸塩、ジ アザビシクロウンデセンシュウ酸塩、ジアザビシクロウ ンデセンイタコン酸塩、ジアザビシクロウンデセンマロ ン酸塩、ジアザビシクロウンデセンギ酸塩、ジアザビシ クロウンデセン酪酸塩、ジアザビシクロウンデセンリン ゴ酸塩などを挙げることができる。これらの中で、水酸 化窒素オニウム塩化合物とカルボン酸窒素オニウム塩化 ジニウム、ノナン酸ピペラジニウム、デカン酸ピペラジ 50 合物を好ましい例として挙げることができ、水酸化アン

モニウム化合物とカルボン酸アンモニウム塩化合物が特 に好ましい。これらの(B)成分は、1種あるいは2種 以上を同時に使用してもよい。

【0030】膜形成用組成物中の(B)成分の使用量 は、(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換 算) に対して0.0001~5重量部であり、より好ま しくは0.0002~2重量部である。(B)成分の添 加量が0.0001重量部未満であると塗膜のクラック 耐性が不十分である場合があり、5重量部を越えると溶 て(B)成分は化合物(1)~(3)の加水分解時の触 媒として使用することも可能であるが、その場合(B) 成分が(A)成分100重量部(完全加水分解縮合物換 算)に対して0.001~5重量部の範囲であれば、 化合物(1)~(3)の加水分解、縮合後、新たに (B) 成分を添加する必要はない。

【0031】(C)有機溶媒

本発明の膜形成用組成物は、(A)成分と(B)成分 を、通常、(C)有機溶媒に溶解または分散してなる。 との(C)有機溶媒としては、アルコール系溶媒、ケト ン系溶媒、アミド系溶媒、エステル系溶媒および非プロ トン系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種が挙げられ る。ここで、アルコール系溶媒としては、メタノール、 エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、n ープタノール、iープタノール、secープタノール、 tープタノール、nーペンタノール、iーペンタノー ル、2-メチルブタノール、sec-ペンタノール、t -ペンタノール、3-メトキシブタノール、n-ヘキサ ノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキサノー ル、2-エチルブタノール、sec-ヘブタノール、> 30 1 1 1 1 5 5 5 5 - 0 + サフルオロ <math>- 2 1 4 - 0プタノール-3、n-オクタノール、2-エチルヘキサ ノール、Sec-オクタノール、n-ノニルアルコー ル、2,6-ジメチルヘプタノール-4、n-デカノー ル、sec-ウンデシルアルコール、トリメチルノニル アルコール、Sec-テトラデシルアルコール、Sec -ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサ ノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリ メチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジア セトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒; 【0032】エチレングリコール、1,2-プロピレン グリコール、1,3-プチレングリコール、ペンタンジ オールー2, 4、2-メチルペンタンジオールー2, 4、ヘキサンジオールー2、5、ヘプタンジオールー 2, 4、2-エチルヘキサンジオール-1, 3、ジエチ レングリコール、ジプロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価ア ルコール系溶媒:エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレン グリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコール

34

エーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、 エチレングリコールモノー2-エチルブチルエーテル、 ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコール モノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチ ルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテ ル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロビ レングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコ ールモノプロピルエーテル、プロピレングリコールモノ 液の保存安定性が劣る場合がある。なお、本発明におい 10 ブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエ ーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、 ジプロピレングリコールモノプロピルエーテルなどの多 価アルコール部分エーテル系溶媒;などを挙げることが できる。これらのアルコール系溶媒は、1種あるいは2 種以上を同時に使用してもよい。

> 【0033】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチルーnープロピルケトン、メチルー n-ブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーi-ブチ ルケトン、メチルーn-ペンチルケトン、エチルーn-20 プチルケトン、メチルーnーヘキシルケトン、ジーiー ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2.4 ーペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョンなどのほか、アセチルアセトン、2, 4-ヘキサンジオン、2,4-ヘプタンジオン、3,5 ーヘブタンジオン、2、4ーオクタンジオン、3、5ー オクタンジオン、2,4-ノナンジオン、3,5-ノナ ンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2, 2, 6, $6 - \mathcal{F} + \mathcal{$ プタンジオンなどのβージケトン類などが挙げられる。 これらのケトン系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時 に使用してもよい。

> 【0034】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、N -メチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミ ド、N-エチルホルムアミド、N, N-ジエチルホルム アミド、アセトアミド、N-メチルアセトアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、N-エチルアセトアミド、 N、Nージエチルアセトアミド、N-メチルプロピオン 40 アミド、N-メチルピロリドン、N-ホルミルモルホリ ン、N-ホルミルピペリジン、N-ホルミルピロリジ ン、N-アセチルモルホリン、N-アセチルピペリジ ン、N-アセチルピロリジンなどが挙げられる。これら アミド系溶媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用し てもよい。

【0035】エステル系溶媒としては、ジェチルカーボ ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、ァーブチロラクトン、ァ - バレロラクトン、酢酸n - プロピル、酢酸 i - プロピ モノブチルエーテル、エチレングリコールモノヘキシル 50 ル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、酢酸sec-ブ

チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エ チルブチル、酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノー チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノブロビルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸n-ブチル、プロピオン酸i-アミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸* R'O (CHCH, CH, O) . R'

(R°およびR°は、それぞれ独立して水素原子、炭素数 20 1~4のアルキル基またはCH,CO-から選ばれる1 価の有機基を示し、eは1~2の整数を表す。)以上の (C) 有機溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使 用するととができる。

【0037】本発明においては、化合物(1)~(3) を加水分解、縮合する際に、同様の溶媒を使用すること ができる。 具体的には、化合物 (1)~(3)を溶解さ せた溶媒中に水または溶媒で希釈した水を断続的あるい は連続的に添加する。との際、触媒は溶媒中に予め添加 散させておいてもよい。との際の反応温度としては、通 常、0~100℃、好ましくは15~90℃である。 【0038】その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにβ-ジケ トン、コロイド状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポ リマー、界面活性剤、シランカップリング剤、ラジカル 発生剤、トリアゼン化合物などの成分を添加してもよ 41

【0039】β-ジケトンとしては、アセチルアセト ン、2,4-ヘキサンジオン、2,4-ヘプタンジオ ン、3、5 - ヘプタンジオン、2、4 - オクタンジオ ン、3,5-オクタンジオン、2,4-ノナンジオン、 3,5-ノナンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサン ジオン、2, 2, 6, 6-テトラメチル-3, 5-ヘプ タンジオン、1、1、1、5、5、5 - ヘキサフルオロ - 2, 4-ヘプタンジオンなどを挙げることができ、よ り好ましくはアセチルアセトン、2, 4-ヘキサンジオ ン、2、4-ヘブタンジオン、3、5-ヘブタンジオン である。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用し ても良い。

*メチル、乳酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は、1 種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。非プロト ン系溶媒としては、アセトニトリル、ジメチルスルホキ シド、N, N, N, N, -テトラエチルスルファミ ド、ヘキサメチルリン酸トリアミド、N-メチルモルホ ロン、N-メチルピロール、N-エチルピロール、N-メチル-Δ3 - ピロリン、N-メチルピペリジン、Nn-ブチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ 10 エチルピペリジン、N, N-ジメチルピペラジン、N-メチルイミダゾール、N-メチル-4-ピペリドン、N -メチル-2-ピペリドン、N-メチル-2-ピロリド ン、1、3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、1、3 -ジメチルテトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノンな どを挙げることができる。

> 【0036】とれらの有機溶剤の中で、特に下記一般式 (4)で表される有機溶剤が特に好ましい。

$\cdots \cdots (4)$

【0040】コロイド状シリカとは、例えば、高純度の 無水ケイ酸を前記親水性有機溶媒に分散した分散液であ り、通常、平均粒径が5~30nm、好ましくは10~ 20nm、固形分濃度が10~40重量%程度のもので ある。とのような、コロイド状シリカとしては、例え ば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよ びイソブロパノールシリカゾル: 触媒化成工業(株) 製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナと しては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、 同100、同200;川研ファインケミカル(株)製の しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分 30 アルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132な どが挙げられる。有機ポリマーとしては、例えば、糖鎖 構造を有する化合物、ビニルアミド系重合体、 (メタ) アクリル系重合体、芳香族ピニル化合物、デンドリマ ー、ポリイミド,ポリアミック酸、ポリアリーレン、ポ リアミド、ポリキノキサリン、ポリオキサジアゾール。 フッ紫系重合体、ポリアルキレンオキサイド構造を有す る化合物などを挙げることができる。

> 【0041】ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物としては、ポリメチレンオキサイド構造、ポリエチ 40 レンオキサイド構造、ポリプロピレンオキサイド構造、 ポリテトラメチレンオキサイド構造、ポリブチレンオキ シド構造などが挙げられる。具体的には、ポリオキシメ チレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキル エーテル、ポリオキシエテチレンアルキルフェニルエー テル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオ キシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホル マリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレ ンポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ポリオキ シエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテルなど 50 のエーテル型化合物、ポリオキシエチレングリセリン脂

肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エ ステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド硫酸 塩などのエーテルエステル型化合物、ポリエチレングリ コール脂肪酸エステル、エチレングリコール脂肪酸エス テル、脂肪酸モノグリセリド、ポリグリセリン脂肪酸エ ステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコ ール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエー テルエステル型化合物などを挙げることができる。ポリ オキシチレンポリオキシプロピレンブロックコポリマー 10 としては下記のようなブロック構造を有する化合物が挙 げられる。

-(X) j - (Y) k -

$-(X) j - (Y) k - (X) 1_{-}$

(式中、Xは-CH,CH,O-で表される基を、Yは-CH, CH (CH,) O-で表される基を示し、jは1~ 90、kは10~99、1は0~90の数を示す) これらの中で、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、 ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックコポ リマー、ポリオキシエチレンポリオキシブロピレンアル 20 キルエーテル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エ ステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステ ル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル、 などのエーテル型化合物をより好ましい例として挙げる ことができる。これらは1種あるいは2種以上を同時に 使用しても良い。

【0042】界面活性剤としては、例えば、ノニオン系 界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活 性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、フッ **素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキ 30** レンオキシド系界面活性剤、ポリ (メタ) アクリレート 系界面活性剤などを挙げることができ、好ましくはフッ 素系界面活性剤、シリコーン系界面活性剤を挙げること ができる。

【0043】フッ素系界面活性剤としては、例えば1. 1, 2, 2-テトラフロロオクチル(1, 1, 2, 2-テトラフロロプロビル) エーテル、1、1、2、2-テ トラフロロオクチルヘキシルエーテル、オクタエチレン グリコールジ(1,1,2,2-テトラフロロブチル) エーテル、ヘキサエチレングリコール(1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロベンチル) エーテル、オクタ プロピレングリコールジ(1, 1, 2, 2-テトラフロ ロブチル) エーテル、ヘキサプロピレングリコールジ (1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロペンチル) エ ーテル、パーフロロドデシルスルホン酸ナトリウム、 1, 1, 2, 2, 8, 8, 9, 9, 10, 10ーデカフ ロロドデカン、1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘキサフロロ デカン、N-[3-(パーフルオロオクタンスルホンア ミド) プロピル] -N. N '-ジメチル-N-カルボキ

ルスルホンアミドプロピルトリメチルアンモニウム塩、 パーフルオロアルキル-N-エチルスルホニルグリシン 塩、リン酸ビス(N-パーフルオロオクチルスルホニル -N-エチルアミノエチル)、モノパーフルオロアルキ ルエチルリン酸エステル等の末端、主鎖および側鎖の少 なくとも何れかの部位にフルオロアルキルまたはフルオ ロアルキレン基を有する化合物からなるフッ素系界面活 性剤を挙げることができる。また、市販品としてはメガ ファックF142D、同F172、同F173、同F1 83 (以上、大日本インキ化学工業(株)製)、エフト ップEF301、同303、同352 (新秋田化成 (株)製)、フロラードFC-430、同FC-431 (住友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG71 O、サーフロンS-382、同SC-101、同SC-102、同SC-103、同SC-104、同SC-1 05、同SC-106(旭硝子(株)製)、BM-10 00、BM-1100(裕商(株)製)、NBX-15 ((株)ネオス)などの名称で市販されているフッ素系 界面活性剤を挙げることができる。これらの中でも、上 記メガファックF172、BM-1000、BM-11 00, NBX-15が特に好ましい。

【0044】シリコーン系界面活性剤としては、例えば SH7PA, SH21PA, SH30PA, ST94P A (いずれも東レ・ダウコーニング・シリコーン (株) 製などを用いることが出来る。これらの中でも、上記S H28PA、SH30PAが特に好ましい。界面活性剤 の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物)に対し て通常0.0001~10重量部である。とれらは1種 あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0045】シランカップリング剤としては、例えば3 - グリシジロキシプロピルトリメトキシシラン、3-ア ミノグリシジロキシプロピルトリエトキシシラン、3-メタクリロキシブロピルトリメトキシシラン、3~グリ シジロキシプロピルメチルジメトキシシラン、1-メタ クリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、3-アミ ノプロビルトリメトキシシラン、3-アミノプロビルト リエトキシシラン、2-アミノプロピルトリメトキシシ ラン、2-アミノプロピルトリエトキシシラン、N-(2-アミノエチル) -3-アミノプロピルトリメトキ 40 シシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノプロ ピルメチルジメトキシシラン、3-ウレイドプロピルト リメトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリエトキシ シラン、N-エトキシカルボニル-3-アミノプロピル トリメトキシシラン、N-エトキシカルボニル-3-ア ミノプロピルトリエトキシシラン、N-トリエトキシシ リルプロピルトリエチレントリアミン、N-トリエトキ シシリルプロピルトリエチレントリアミン、10-トリ メトキシシリルー1, 4, 7-トリアザデカン、10-トリエトキシシリルー1, 4, 7-トリアザデカン、9 シメチレンアンモニウムベタイン、パーフルオロアルキ 50 -トリメトキシシリル-3,6-ジアザノニルアセテー

ト、9-トリエトキシシリル-3、6-ジアザノニルア セテート、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリメト キシシラン、N-ベンジル-3-アミノプロピルトリエ トキシシラン、 N-フェニル-3-アミノプロピルトリ メトキシシラン、N-フェニル-3-アミノプロピルト リエトキシシラン、N-ビス(オキシエチレン)-3-アミノプロビルトリメトキシシラン、N-ビス (オキシ エチレン) -3-アミノプロピルトリエトキシシランな どが挙げられる。 これらは1種あるいは2種以上を同時 に使用しても良い。

39

【0046】ラジカル発生剤としては、例えばイソブチ リルパーオキサイド、 α 、 α ' ビス (ネオデカノイルバ ーオキシ)ジイソプロピルベンゼン、クミルパーオキシ ネオデカノエート、ジーnプロビルパーオキシジカーボ ネート、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、 1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシネオデ カノエート、ピス(4-t-ブチルシクロヘキシル)パ ーオキシジカーボネート、1-シクロヘキシル-1-メ チルエチルパーオキシネオデカノエート、ジー2-エト ヘキシルバーオキシ) ジカーボネート、t - ヘキシルバ ーオキシネオデカノエート、ジメトキブチルパーオキシ ジカーボネート、ジ(3-メチル-3-メトキシブチル パーオキシ) ジカーボネート、t - ブチルパーオキシネ オデカノエート、2、4-ジクロロベンゾイルパーオキ サイド、t‐ヘキシルパーオキシピバレート、t‐ブチ ルパーオキシピバレート、3,5,5-トリメチルヘキ サノイルパーオキサイド、オクタノイルパーオキサイ ド、ラウロイルバーオキサイド、ステアロイルバーオキ シ2-エチルヘキサノエート、スクシニックパーオキサ イド、2、5ージメチルー2、5ージ(2ーエチルヘキ サノイルパーオキシ) ヘキサン、1-シクロヘキシルー 1-メチルエチルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t-ヘキシルパーオキシ2-エチルヘキサノエー ト、t - ブチルパーオキシ2 - エチルヘキサノエート、 m-トルオイルアンドベンゾイルパーオキサイド、ベン ゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシイソブチ レート、ジーt-ブチルパーオキシ-2-メチルシクロ ヘキサン、1, 1-ビス(t-ヘキシルパーオキシ)- 40 3, 3, 5-トリメチルシクロヘキサン、1, 1-ビス (t-ヘキシルパーオキシ)シクロヘキサン、1.1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3,3,5-トリメチ ルシクロヘキサン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキ シ) シクロヘキサン、2, 2-ビス(4, 4-ジ-t-ブチルパーオキシシクロヘキシル) プロパン、1,1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロデカン、t-ヘキ シルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブ チルパーオキシマレイン酸、t-ブチルパーオキシー

ーオキシラウレート、2,5ージメチルー2,5ージ (m-トルオイルパーオキシ) ヘキサン、t-ブチルパ ーオキシイソプロビルモノカーボネート、t-ブチルバ ーオキシ2-エチルヘキシルモノカーボネート、t-ヘ キシルパーオキシベンゾエート、2.5-ジメチルー 2. 5-ジ (ベンゾイルパーオキシ) ヘキサン、 t-ブ チルパーオキシアセテート、2,2-ビス(t-ブチル パーオキシ) ブタン、t-ブチルパーオキシベンゾエー ト、n-ブチル-4, 4-ビス(t-ブチルパーオキ 10 シ) バレレート、ジー t - ブチルパーオキシイソフタレ -ト、 α 、 α ビス (t - ブチルパーオキシ) ジイソプ ロピルベンゼン、ジクミルパーオキサイド、2.5-ジ メチル-2, 5-ジ(t-ブチルパーオキシ) ヘキサ ン、t-ブチルクミルパーオキサイド、ジーt-ブチル パーオキサイド、p-メンタンヒドロパーオキサイド 2, 5 - ジメチル - 2, 5 - ジ(t - ブチルパーオキシ) ヘキシン-3、ジイソプロピルベンゼンヒドロパー オキサイド、t-ブチルトリメチルシリルパーオキサイ ド、1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチルヒドロパーオ キシエチルパーオキシジカーボネート、ジ(2-エチル 20 キサイド、クメンヒドロパーオキサイド、 t-ヘキシル ヒドロパーオキサイド、t-ブチルヒドロパーオキサイ ド、2、3-ジメチル-2、3-ジフェニルブタン等を 挙げることができる。ラジカル発生剤の配合量は、重合 体100重量部に対し、0.1~10重量部が好まし い。これらは1種あるいは2種以上を同時に使用しても 良い。

【0047】トリアゼン化合物としては、例えば、1. 2-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、 1, 3-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼ サイド、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルバーオキ 30 ン、1, 4-ビス(3, 3-ジメチルトリアゼニル) ベ ンゼン、ビス(3、3-ジメチルトリアゼニルフェニ ル) エーテル、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニルフ ェニル) メタン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル フェニル)スルホン、ビス(3,3-ジメチルトリアゼ ニルフェニル)スルフィド、2,2-ビス[4-(3. 3-ジメチルトリアゼニルフェノキシ)フェニル]-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロバン、 2, 2-ビス〔4-(3, 3-ジメチルトリアゼニルフ ェノキシ)フェニル]プロパン、1、3、5-トリス (3, 3-ジメチルトリアゼニル)ベンゼン、2, 7-ピス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9.9-ピス [4-(3,3-ジメチルトリアゼニル)フェニル]フ ルオレン、2、7-ビス(3、3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス[3-メチル-4-(3, 3-ジメ チルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7-ビ ス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9.9-ビス [3-フェニル-4-(3, 3-ジメチルトリアゼニ ル)フェニル]フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジ メチルトリアゼニル)-9,9-ビス[3-プロペニル 3, 3, 5- トリメチルヘキサノエート、t-ブチルパ 50 -4- (3, 3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フ

ルオレン、2、7-ビス(3、3-ジメチルトリアゼニ ル) -9, 9-ビス[3-フルオロ-4-(3, 3-ジ メチルトリアゼニル)フェニル]フルオレン、2,7-ビス(3,3-ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス [3, 5-ジフルオロ-4-(3, 3-ジメチルトリア ゼニル) フェニル] フルオレン、2、7-ビス(3,3 -ジメチルトリアゼニル)-9,9-ビス[3-トリフ ルオロメチルー4-(3,3-ジメチルトリアゼニル) フェニル] フルオレンなどが挙げられる。これらは1種 あるいは2種以上を同時に使用しても良い。

【0048】このようにして得られる本発明の組成物の 全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、 使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃 度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲 となり、保存安定性もより優れるものである。なお、と の全固形分濃度の調整は、必要であれば、濃縮および上 記(C)有機溶剤による希釈によって行われる。

【0049】本発明の組成物を、シリコンウエハ、Si O₂ウエハ、S i Nウエハなどの基材に塗布する際に は、スピンコート、浸漬法、ロールコート法、スプレー 20 法などの塗装手段が用いられる。この際の膜厚は、乾燥 膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~2.5μm程 度、2回塗りでは厚さ0.1~5.0μm程度の塗膜を 形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あ るいは80~600℃程度の温度で、通常、5~240 分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨 大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加 熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネ スなどを使用することが出来、加熱雰囲気としては、大 気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度 30 をコントロールした減圧下などで行うことができる。ま た、電子線や紫外線を照射することによっても塗膜を形 成させることができる。また、上記塗膜の硬化速度を制 御するため、必要に応じて、段階的に加熱したり、窒 素、空気、酸素、減圧などの雰囲気を選択することがで きる。さらに、本発明のシリカ系膜の比誘電率は、通 常、3.0~1.2、好ましくは3.0~1.8、さら に好ましくは3.0~2.0である。

【0050】このようにして得られる層間絶縁膜は、短 時間焼成が可能であり、クラック耐性、低吸湿性に優れ 40 ×:クラックの伝播認められる ることから、LSI、システムLシ、DRAM、SDR AM、RDRAM、D-RDRAMなどの半導体素子用 層間絶縁膜やエッチングストッパー膜、半導体素子の表 面コート膜などの保護膜、多層レジストを用いた半導体 作製工程の中間層、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表 示素子用の保護膜や絶縁膜などの用途に有用である。

[0051]

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的 に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を

より本発明は限定されるものではない。なお、実施例お よび比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞ れ重量部および重量%であることを示している。また、 各種の評価は、次のようにして行なった。

【0052】重量平均分子量(Mw)

(22)

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ - (GPC) 法により測定した。

試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶 10 解して調製した。

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標 準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマ トグラム(モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M (長さ50cm)

測定温度:40℃ 流速:1cc/分 【0053】比誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 420℃の窒素雰囲気ホットプレートで15分基板を焼 成した。得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム 電極バターンを形成させ比誘電率測定用サンブルを作成 した。該サンプルを周波数 I O O k H z の周波数で、横 河・ヒューレットパッカード (株) 製、HP16451 B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータ を用いてCV法により当該塗膜の比誘電率を測定した。

【0054】クラック耐性

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 420℃の窒素雰囲気ホットプレートで15分基板を焼 成した。この際の塗膜の膜厚は1.4μmとした。得ら れた塗膜の一部をナイフで傷を付け、純水中に48時間 浸漬した。塗膜中のナイフの傷跡を顕微鏡で観察し、以 下の基準で評価した。

〇:クラックの伝播認められない。

【0055】吸湿性

8 インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で90℃で3分 間、窒素雰囲気200℃で3分間基板を乾燥し、さらに 420℃の窒素雰囲気ホットプレートで15分基板を焼 成した。次いで、焼成基板をクリーンルーム内で23 ℃、50%RHの雰囲気で2週間放置後、吸湿性をTD S装置(電子科学製、EMD-WAlOOS型)を用い て評価した。評価条件は、以下のとおりである。すなわ 概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載に 50 ち、 $1\, extbf{C}/ extbf{s}$ $\, extbf{e}$ $\, extbf{c}$. の昇温速度で室温から $\, extbf{6}$ $\, extbf{0}$ $\, extbf{0}$ $\, extbf{C}$ $\, extbf{z}$

加熱してTDSスペクトルを測定し、水のフラグメント (M/Z=18)の室温から400℃までの面積を膜厚 500nm換算で求める。その際、8インチシリコンウ エハ上に形成したCVD法SiO2 膜の水のフラグメ ント (M/2=18)の面積を同様にして求め、両者の 面積比(組成物/CVD法SiO2)で吸湿性を評価 した。

〇:塗膜の吸湿性がCVD法SiO2 膜以下 ×: 塗膜の吸湿性がCVD法SiO2 膜超える 【0056】合成例1

石英製セパラブルフラスコ中で、メチルトリメトキシシ ラン77.04 gとテトラメトキシシラン24.05 g とテトラキス (アセチルアセトナート) チタン0.48 8を、プロピレングリコールモノエチルエーテル290 gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、 溶液温度を60℃に安定させた。次に、イオン交換水8 4gを1時間かけて溶液に添加した。その後、60℃で 2時間反応させたのち、アセチルアセトン25gを添加 し、さらに30分間反応させ、反応液を室温まで冷却し た。50℃で反応液からメタノールと水を含む溶液を1 20 実施例2~13 49gエバポレーションで除去し、反応液Φを得た。と のようにして得られた縮合物等の重量平均分子量は、 3,900であった。

【0057】合成例2

石英製セパラブルフラスコに、エタノール570g、イ オン交換水160gと10%ジメチルアミン水溶液90* * gを入れ、均一に撹拌した。この溶液にメチルトリメト キシシラン13.6 g とテトラエトキシシラン20.9 gの混合物を30分間かけて添加した。溶液を65℃に 保ったまま、2時間反応を行った。この溶液にプロピレ ングリコールモノプロビルエーテル3000gを加え、 その後、50℃のエバボレーターを用いて溶液を10% (完全加水分解縮合物換算)となるまで濃縮し、反応液 ②を得た。このようにして得られた縮合物等の重量平均 分子量は、993,000であった。

10 実施例1

合成例1で得られた反応液の100gにトリエタノール アミン0.002gを添加し十分攪拌した。この溶液を O. 2μm孔径のテフロン (登録商標) 製フィルターで ろ過を行い本発明の膜形成用組成物を得た。得られた組 成物をスピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。 塗膜の比誘電率は2.67と低い値であり、塗膜を水浸 潰してもクラックの伝播は認められなかった。また、塗 膜の吸湿性を評価したととろ、CVD法SiO2膜以下 の低吸湿性を示した。

実施例1において、表1および表2に示す反応液と (B) 成分を使用した以外は実施例1と同様に評価を行 った。評価結果を表1および表2に併せて示す。 [0058]

【表1】

実施例	(A)成分	(B)成分	比誘電率	ダラック	吸湿性
1	反応被① 100g	トリエタノールブミン 0.002g	2. 67	0	0
2		トリエタノールアミン-シュウ酸塩 0.002g	2. 63	0	0
3	反応液① 100g	シ'ブす' ヒ'シクロウンデ' セン 0.001g	2. 71	0	0
4	反応液①	テトラ <i>弁レ</i> アンモニウムハイト ロオキャイト・- マレイン酸塩 0.001g	2. 62	0	0
5		シ゚アサ゚ピシクロウンテ゚セン-酢酸塩 0.001g	2.63	0	0
6	反応液① 100g	水酸化トリフ*チルアンモニウム 0.002g	2. 83	0	0
7	反応液① 100g	ジアザビシクロウンデセンーマレイン酸 塩 0.002g	2. 82	0	0
8		水酸化テトラ <i>メチルエンキニウム-シュウ</i> 酸 塩 0.001g	2. 81	0	0

46

実施例	(A)成分	(B)成分	比誘電率	グラック	吸湿性
9	反応液② 100g	シ*アザビシクロウンデセン酢酸 塩 0.001g	2. 20	0	0
10	反応被② 100g	テトラ <i>バチル</i> アンモニウムハイト・ロオキサイ ト* 0.001g	2. 21	0	0
11	反応液② 100g	テトラバチがプンモニウムハイト ロオキサイト・マルル酸塩 0.001g	2. 19	0	0
1 2	反応被② 100g	酢酸テトラメチルアンモニウム塩 0.001g	2. 18	0	0
13	反応被② 100g	ジアザビシタロ/ナン-マレイン酸 0.001g	2. 21	0	0

【0060】比較例1

合成例1で得られた反応液Φのみを使用した以外は実施 は3.10と高い値であり、塗膜を水浸漬したところク ラックの伝播が認められた。また、塗膜の吸湿性を評価 したところ、CVD法SiO2膜を超える吸湿性を示し

* [0061]

【発明の効果】本発明によれば、アルコキシシラン加水 例1と同様にして塗膜の評価を行った。塗膜の比誘電率 20 分解重合体にアルカリ化合物および/またはアルカリ化 合物塩を添加することで、短時間焼成が可能であり、ク ラック耐性、低吸湿性に優れた膜形成用組成物(層間絶 縁膜用材料)を提供することが可能である。

フロントページの続き

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J035 BA06 BA16 CA022 CA112 CA142 CA162 CA192 EA01 EB03 HA01 HA02 HA06 HB03 LA03 LB01

> 4J038 DL021 DL031 DL161 GA01 GA02 GA03 GA12 HA176 HA266 JA18 JA20 JA26 JA33 JA34 JA37 JA38 JA40 JA44 JA56 JB01 JB03 JB11 JB13 JB25 JB27 JB29 JB30 JB32 JC13 JC38 KA04 LA06 MA07 NA04 NA21 NA24 PA19 PB09 PB11 PC02 PC08